



SUPPLEMENTARY
EUROPEAN SEARCH REPORT

DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		Relevant to claim	CLASSIFICATION OF THE APPLICATION (Int.Cl.6)
Category	Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages		
A ✓	IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, vol. EDL-6, no. 8, August 1985, NEW YORK US, pages 437-438, XP002033693 R.D. REMBA ET AL.: "Use of a TiN barrier to improve GaAs FET ohmic contact reliability" * the whole document * ---	1	H01L21/28
A ✓	US 4 833 042 A (WALDROP ET AL.) * the whole document * ---	1	
A ✓	US 5 089 438 A (KATZ) * the whole document * ---	1	
A ✓	US 5 027 187 A (O'MARA, JR. ER AL.) * the whole document * ---	1	
D,A ✓	JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, vol. 68, no. 5, 1 September 1990, pages 2475-2481, XP000108786 KIM H -J ET AL: "THERMALLY STABLE OHMIC CONTACTS TO N-TYPE GAAS. VIII SPUTTER-DEPOSITED INAS CONTACTS" -----		<p>TECHNICAL FIELDS SEARCHED (Int.Cl.6)</p> <p>H01L</p>
The supplementary search report has been drawn up for the claims attached hereto.			
2	Place of search	Date of completion of the search	Examiner
	THE HAGUE	25 June 1997	Baillet, B
CATEGORY OF CITED DOCUMENTS			
X : particularly relevant if taken alone Y : particularly relevant if combined with another document of the same category A : technological background O : non-written disclosure P : intermediate document			
T : theory or principle underlying the invention E : earlier patent document, but published on, or after the filing date D : document cited in the application L : document cited for other reasons & : member of the same patent family, corresponding document			

THIS PAGE BLANK (USPTO)

A handwritten signature or mark consisting of a stylized, cursive 'S' shape followed by a horizontal line.



Austrian Patent Office Service and Information Sector (TRF)

To

REGISTRY OF PATENTS
51 Bras Basah Road
#04-01 Plaza By The Park

SINGAPORE 0718

Kohlmarkt 8-10
A - 1014 VIENNA
Austria

Tel.No.: ++431/53424/0
Fax.No.: ++431/53424/520

Date of mailing:

Applicant: **SONY CORPORATION**

Application No.: 9702687-6	Filing Date: 20 August 1996 (20.08.1996)	(Earliest) Priority Date: 24 August 1995 (24.08.1995)
--------------------------------------	---	--

International Patent Classification (IPC⁶): **H01L 21/28**

Please find enclosed the

- SEARCH REPORT**
- EXAMINATION REPORT**
- WRITTEN OPINION**

provided by the Austrian Patent Office as Search and Examination Authority according to the Memorandum of Understanding between the Government of Singapore and the Austrian Patent Office (MOU)

Best regards

AUSTRIAN PATENT OFFICE
Service and Information
Sector TRF

P. NEGWER

Telephone No.: ++431/53424/180

Enclosures:

- the search report
(it is also accompanied by a copy of each prior art document cited in the report)
- the examination report
- the written opinion
- the Registry's copy of the priority application

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Austrian Patent Office

Application No.:	9702687-6	Applicant:	SONY CORPORATION
Filing date:	20 August 1996 (20.08.1996)	(Earliest) Priority Date:	24 August 1995 (24.08.1995)

GENERAL OBSERVATIONS

With regard to the abstract,

- the text is approved as submitted by the applicant.
- the text has been established by this Authority as it appears on the following page.

The Searching and Examining Authority

- considers that the unity of invention is complied with the requirement of section 25 (5) of the Singapore Patents Act.
- The Searching and Examining Authority found multiple inventions in this application. This search report is therefore restricted to the invention first mentioned in the claims, it is covered by claims Nos.:
The Authority will establish the search (and/or examination) report(s) on the other parts of the application only if (an) additional search (and/or examination) report(s) will be requested.

With regards to section 13 (3) and (4) of the Singapore Patents Act the application contains neither statements disparaging any person nor expressions etc. contrary to morality or public order.

- The applicant is thereby invited to reply to this opinion within months from the date of the Registrar's letter enclosing the written opinion.
How? By submitting a written reply, accompanied where appropriate, by the amendments.
If no reply is filed, the examination report will be established on the basis of this opinion.
The applicant's attention is drawn to the fact that a later submission will be considered not to have been made and will therefore not be taken into account.
- Further remarks:

AUSTRIAN PATENT OFFICE
Kohlmarkt 8-10, A-1014 VIENNA
Facsimile No. + +431/53424/0

Authorized Officer BERGER

Telephone No. + +431/53424/453

THIS PAGE BLANK (USP 10)



SEARCH REPORT

Application No.:

9702687-6

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

According to the International Patent Classification (IPC⁶): H01L 21/28B. FIELDS SEARCHED: IPC⁶

H01L

Electronic data base consulted during the search (name of data base and, where practicable, search terms used):

WPIL

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5027187 A (O'MARA JR., et al.) 25 June 1991 (25.06.91), abstract, fig. 1, claims 1-4, column 1, lines 11-53. --	1-19
A	EP 0559182 A2 (SUMITOMO ELECTRIC IND. LTD.) 8 September 1993 (08.09.93), abstract, fig 1-13, claims 1-10. --	1-19
A	EP 0649167 A2 (SONY CORP.) 19 April 1995 (19.04.95) abstract, fig. 1, 3, 4, claim 1, column 3, line 34 – column 8, line 17. ----	1-19

 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of actual completion of the search: 27 July 1998 (27.07.1998)

AUSTRIAN PATENT OFFICE
Kohlmarkt 8-10, A-1014 VIENNA

Authorized Officer BERGER

Facsimile No. ++431/53424/0

Telephone No. ++431/53424/453

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Austrian Patent Office

Application No.:	9702687-6	Applicant:	SONY CORPORATION
Filing date:	20 August 1996 (20.08.1996)	(Earliest) Priority Date:	24 August 1995 (24.08.1995)

SEARCH REPORT

EXPLANATIONS

The cited document US 5027187 A (O'MARA JR. et al.) shows a polycrystalline silicon layer which forms an ohmic contact to a group III-arsenide compound semiconductor substrate by heating the substrate.

The cited document EP 0559182 A2 (SUMITOMO ELECTRIC IND. LTD.) shows a high productivity and low resistance ohmic electrode which consists of a gold-germanium-nickel alloy for semiconductor devices.

The cited document EP 0649167 A2 (SONY CORP.) shows an ohmic electrode for III-V compound semiconductors such as GaAs semiconductors having practically satisfactory characteristics.

THIS PAGE BLANK (USPTO)



SEARCH REPORT

Information on patent family members

Application No.:

9702687-6

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the search report.

The members are as contained in the EPIDOS INPADOC file.

The Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information

Patent document cited in the search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date

US A 5027187
EP A2 559182

25-06-91
08-09-93

AU A1	33934/93	09-09-93
AU A1	30147/93	19-10-95
AU A1	30148/93	19-10-95
AU B2	663757	19-10-95
CA AA	2090789	04-09-93
EP A3	559182	10-05-95
US A	5422307	06-06-95
JP A2	5326518	10-12-93
JP A2	5167063	02-07-93

EP A2 649167

19-04-95

EP A3	649167	24-09-97
JP A2	7094444	07-04-95
US A	5767007	16-06-98

THIS PAGE BLANK (USPTO)



EXAMINATION REPORT
 WRITTEN OPINION

Application No.:

9702687-6

Reasoned statement with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement

1. STATEMENT

Novelty (N)	YES: Claims	1-19
	NO: Claims	—
Inventive Steps (IS)	YES: Claims	1-19
	NO: Claims	-----
Industrial applicability (IA)	YES: Claims	1-19
	NO: Claims	-----

2. CITATIONS AND EXPLANATIONS

The documents cited in the search report merely disclose the state of the art.

There is also an inventive step involved. The industrial applicability is given since the present application concerns a laminate for forming an ohmic electrode.

Date of actual completion of the report / opinion: 27 July 1998 (27.07.1998)

THIS PAGE BLANK (USPTO)

特許協力条約

EP

US

PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)
[PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 S96P724WO00	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220)及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP96/02318	国際出願日 (日.月.年) 20.08.96	優先日 (日.月.年) 24.08.95
出願人(氏名又は名称) ソニー株式会社		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 2 ページである。

この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。
2. 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。
3. この国際出願は、スクレオチド及び/又はアミノ酸配列リストを含んでおり、次の配列リストに基づき国際調査を行った。
 - この国際出願と共に提出されたもの
 - 出願人がこの国際出願とは別に提出したもの
 - しかし、出願時の国際出願の開示の範囲を越える事項を含まない旨を記載した書面が添付されていない
 - この国際調査機関が書換えたもの
4. 発明の名称は 出願人が提出したものと承認する。
 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は 出願人が提出したものと承認する。
 第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。
6. 要約書とともに公表される図は、
 第4図とする。 出願人が示したとおりである. なし
 出願人は図を示さなかった。
 本図は発明の特徴を一層よく表している。

THIS PAGE BLANK (USPTO)

08/809463

特許協力条約に基づく国際出願

願書

21 APR 1997

出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されることを請求する。

国際出願番号

国際出願日

(受付印)

PCT

20.8.96

受領印

出願人又は代理人の書類記号
(希望する場合は最大12字)

S96P724W000

第I欄 発明の名称

オームック電極形成用積層体およびオームック電極

第II欄 出願人

氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)

 この欄に記載した者は、
発明者である。

ソニー株式会社

SONY CORPORATION

〒141 日本国 東京都品川区北品川6丁目7番35号

電話番号:
03-5448-2111

7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, TOKYO

ファクシミリ番号:
03-5448-5709

141 JAPAN

加入電信番号:
J22262

国籍(国名): 日本国 JAPAN

住所(国名): 日本国 JAPAN

この欄に記載した者は、次の
指定国についての出願人である:

すべての指定国 米国を除くすべての指定国 米国のみ 追記欄に記載した指定国

第III欄 その他の出願人又は発明者

氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)

この欄に記載した者は
次に該当する:

中村光宏 NAKAMURA Mitsuhiro

 出願人である。

〒141 日本国 東京都品川区北品川6丁目7番35号

 出願人及び発明者である。

ソニー株式会社内

 発明者である。
(ここにレ印を付したときは、以下に記入しないこと)C/O SONY CORPORATION, 7-35, Kitashinagawa 6-chome,
Shinagawa-ku, TOKYO 141 JAPAN

国籍(国名): 日本国 JAPAN

住所(国名): 日本国 JAPAN

この欄に記載した者は、次の
指定国についての出願人である:

すべての指定国 米国を除くすべての指定国 米国のみ 追記欄に記載した指定国

 その他の出願人又は発明者が統括に記載されている。

第IV欄 代理人又は共通の代表者、通称のあて名

次に記載された者は、国際機関において出願人のために行動する:

 代理人 共通の代表者

氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)

電話番号:

8276 弁理士 杉浦正知 SUGIURA Masatomo

03-3980-0339

〒170 日本国 東京都豊島区東池袋1丁目48番10号

ファクシミリ番号:

25山京ビル 420号

03-3982-3166

Room 420, 25 Sankyo Bldg., 48-10,

加入電信番号:

Higashi Ikebukuro 1-chome,

Toshima-ku, TOKYO 170 JAPAN

 代理人又は共通の代表者が選任されていないときに、通知が送付されるあて名を記載する場合はレ印を付す

THIS PAGE BLANK (USPTO)

第三欄の統計

その他の出願人又は発明者

この統計を使用しないときは、この用紙を願書に添付する必要はない。

氏名（名称）及びあて名：（姓・名の順に記載；法人は公式の完全な名称を記載；あて名は郵便番号及び国名も記載）

和田 勝 WADA Masaru

〒141 日本国 東京都品川区北品川6丁目7番35号

ソニー株式会社内

C/O SONY CORPORATION, 7-35, Kitashinagawa 6-chome,
Shinagawa-ku, TOKYO 141 JAPANこの欄に記載した者は、
次に該当する： 出願人である。 出願人及び発明者である。 発明者である。
(ここにレ印を付したときは、以下に記入しないこと)

国籍（国名）： 日本国 JAPAN

住所（国名）： 日本国 JAPAN

この欄に記載した者は、次の

 すべての指定国 米国を除くすべての指定国 米国のみ 追記欄に記載した指定国

指定国についての出願人である：

氏名（名称）及びあて名：（姓・名の順に記載；法人は公式の完全な名称を記載；あて名は郵便番号及び国名も記載）

内堀 千尋 UCHIBORI Chihiro

〒606 日本国 京都府京都市左京区吉田本町（番地なし）

京都大学工学部金属加工学教室内

C/O DEPARTMENT OF METAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, FACULTY
OF ENGINEERING, KYOTO UNIVERSITY, YOSHIDAHON-MACHI,
SAKYO-KU, KYOTO-SHI, KYOTO-FU 606 JAPANこの欄に記載した者は、
次に該当する： 出願人である。 出願人及び発明者である。 発明者である。
(ここにレ印を付したときは、以下に記入しないこと)

国籍（国名）： 日本国 JAPAN

住所（国名）： 日本国 JAPAN

この欄に記載した者は、次の

 すべての指定国 米国を除くすべての指定国 米国のみ 追記欄に記載した指定国

指定国についての出願人である：

氏名（名称）及びあて名：（姓・名の順に記載；法人は公式の完全な名称を記載；あて名は郵便番号及び国名も記載）

村上 正紀 MURAKAMI Masanori

〒606 日本国 京都府京都市左京区吉田本町（番地なし）

京都大学工学部金属加工学教室内

C/O DEPARTMENT OF METAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, FACULTY
OF ENGINEERING, KYOTO UNIVERSITY, YOSHIDAHON-MACHI,
SAKYO-KU, KYOTO-SHI, KYOTO-FU 606 JAPANこの欄に記載した者は、
次に該当する： 出願人である。 出願人及び発明者である。 発明者である。
(ここにレ印を付したときは、以下に記入しないこと)

国籍（国名）： 日本国 JAPAN

住所（国名）： 日本国 JAPAN

この欄に記載した者は、次の

 すべての指定国 米国を除くすべての指定国 米国のみ 追記欄に記載した指定国

指定国についての出願人である：

氏名（名称）及びあて名：（姓・名の順に記載；法人は公式の完全な名称を記載；あて名は郵便番号及び国名も記載）

この欄に記載した者は、
次に該当する： 出願人である。 出願人及び発明者である。 発明者である。
(ここにレ印を付したときは、以下に記入しないこと)

国籍（国名）：

住所（国名）：

この欄に記載した者は、次の

 すべての指定国 米国を除くすべての指定国 米国のみ 追記欄に記載した指定国

指定国についての出願人である：

 その他の出願人又は発明者が統計に記載されている。

THIS PAGE BLANK (USPTO)

第V欄 国の指定

規則 4.9(a)の規定に基づき次の国を指定する(該当する□内にレ印を付すこと、及び少なくとも1国を指定すること)。

廣城特許

- AP** ARIPO特許 : **KE** ケニア Kenya, **LS** レソト Lesotho, **MW** マラウイ Malawi, **SD** スーダン Sudan.
SZ スワジランド Swaziland, **UG** ウガンダ Uganda. 及びハラブロトコルと特許協力条約の締約国である他の国

EA ユーラシア特許 : **AZ** アゼルバイジャン Azerbaijan, **BY** ベラルーシ Belarus, **KZ** カザフスタン Kazakhstan.
RU ロシア連邦 Russian Federation, **TJ** タジキスタン Tajikistan, **TM** トルクメニスタン Turkmenistan. 及びユーラシア特許条約と特許協力条約の締約国である他の国

EP ヨーロッパ特許 : **AT** オーストリア Austria, **BE** ベルギー Belgium, **CH and LI** スイス及びリヒテンシュタイン Switzerland and Liechtenstein, **DE** ドイツ Germany, **DK** デンマーク Denmark, **ES** スペイン Spain,
FR フランス France, **GB** 英国 United Kingdom, **GR** ギリシャ Greece, **IE** アイルランド Ireland,
IT イタリア Italy, **LU** ルクセンブルグ Luxembourg, **MC** モナコ Monaco, **NL** オランダ Netherlands,
PT ポルトガル Portugal, **SE** スウェーデン Sweden. 及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国である他の国

OA OAPI特許 : **BF** ブルキナ・ファソ Burkina Faso, **BJ** ベナン Benin, **CF** 中央アフリカ Central African Republic, **CG** コンゴ Congo, **CI** 象牙海岸 Côte d'Ivoire, **CM** カメルーン Cameroon, **GA** ガボン Gabon,
GN ギニア Guinea, **ML** マリ Mali, **MR** モーリタニア Mauritania, **NE** ニジェール Niger,
SN セネガル Senegal, **TD** チャード Chad, **TG** トーゴ Togo. 及びアフリカ知的所有権機構と特許協力条約の締約国である他の国(他のOAPI保護を求める場合には点線上に記載する)

国内特許（他の種類の保護又は取扱いを求める場合には点線上に記載する）

- A L** アルバニア Albania
 A M アルメニア Armenia
 A T オーストリア Austria
 A U オーストラリア Australia
 A Z アゼルバイジャン Azerbaijan
 B B バルバドス Barbados
 B G ブルガリア Bulgaria
 B R ブラジル Brazil
 B Y ベラルーシ Belarus
 C A カナダ Canada
 C H and L I スイス及びリヒテンシュタイン
Switzerland and Liechtenstein

 C N 中国 China
 C Z チェコ Czech Republic
 D E ドイツ Germany
 D K デンマーク Denmark
 E E エストニア Estonia
 E S スペイン Spain
 F I フィンランド Finland
 G B 英国 United Kingdom
 G E グルジア Georgia
 H U ハンガリー Hungary
 I S アイスランド Iceland
 J P 日本 Japan
 K E ケニア Kenya
 K G キルギスタン Kyrgyzstan
 K R 韓国 Republic of Korea
 K Z カザフスタン Kazakhstan
 L K スリ・ランカ Sri Lanka
 L R リベリア Liberia
 L S レソト Lesotho
 L T リトアニア Lithuania
 L U ルクセンブルグ Luxembourg
 L V ラトヴィア Latvia
 M D モルドヴァ Republic of Moldova
 M G マダガスカル Madagascar
 M K マケドニア旧ユーゴスラヴィア The former Yugoslav Republic of Macedonia

- MN** モンゴル Mongolia
 - MW** マラウイ Malawi
 - MX** メキシコ Mexico
 - NO** ノールウェー Norway
 - NZ** ニュー・ジーランド New Zealand
 - PL** ポーランド Poland
 - PT** ポルトガル Portugal
 - RO** ルーマニア Romania
 - RU** ロシア連邦 Russian Federation
 - SD** スーダン Sudan
 - SE** スウェーデン Sweden
 - SG** シンガポール Singapore
 - SI** スロヴェニア Slovenia
 - SK** スロヴァキア Slovakia
 - TJ** タジキスタン Tajikistan
 - TM** トルクメニスタン Turkmenistan
 - TR** トルコ Turkey
 - TT** トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago
 - UA** ウクライナ Ukraine
 - UG** ウガンダ Uganda
 - US** 米国 United States of America

 - UZ** ウズベキスタン Uzbekistan
 - VN** ベトナム Vietnam

下の欄は、この様式の施行後に特許協力条約の締約国となった国を指定（国内特許のために）するためのものである

THIS PAGE BLANK (USPTO)

第 VI 構成 優先権主張

他の優先権の主張が追記欄に記載されている

下記の先の出願に基づく優先権を主張する

国名 (その国において又はその 国について出願がされた)	先の出願の日 (日、月、年)	先の出願の番号	先の出願がされた官庁名 (広域出願又は国際出願のみ)
(1) 日本国 JAPAN	24.08.95	平成7年特許願 第239120号	
(2)			
(3)			

先の出願が、本件国際出願について受理官庁である国内官庁に対して行われたときは、出願人は、手数料の納付を条件に以下を請求する。

 上記の先の出願のうち次の番号の出願書類の認証書を作成し国際事務局へ送付することを特許庁長官に請求している。

第 VII 構成 國際調査機関

國際調査機関 (ISA) の選択

先の出願にて 国際調査機関による調査(国際・国際型又はその他)を既に請求しており、可能な限り当該調査の結果を国際調査の基礎とすることを請求する場合に記入する。関連する出願(若しくはその翻訳)又は関連する調査請求を表示することにより当該調査又は請求を特定する:

国名(又は広域官庁)

出願日(日、月、年)

番号

第 VIII 構成 共同合意

この国際出願の用紙の枚数は次のとおりである。

1. 願書	4枚
2. 明細書	19枚
3. 請求の範囲	3枚
4. 要約書	1枚
5. 図面	8枚
合計	35枚

出願時におけるこの国際出願には、以下にチェックした書類が添付されている。

- | | |
|---|--|
| 1. <input type="checkbox"/> 別個の記名押印された委任状 | 5. <input checked="" type="checkbox"/> 所定の手数料の納付 |
| 2. <input type="checkbox"/> 包括委任状の写し | 6. <input checked="" type="checkbox"/> 納付する手数料に相当する特許印紙を貼付した書面 |
| 3. <input type="checkbox"/> 記名押印(署名)の説明書 | 7. <input checked="" type="checkbox"/> 国際事務局の口座への振込みを証明する書面 |
| 4. <input checked="" type="checkbox"/> 上記第VI欄に記載された優先権書類
(具体的に記載する): (1) | 8. <input type="checkbox"/> 寄託した微生物に関する書面 |
| | 9. <input type="checkbox"/> ヌクレオチド及び/又はアミノ酸配列リスト
(フレキシブルディスク) |
| | 10. <input type="checkbox"/> その他(具体的に記載する) |

要約書とともに公表する図として 第 _____ 図 を提示する(図面がある場合)

第 IX 構成 提出者の記名押印

本人の氏名を記載し、その次に押印する。願書により資格が明白に表示されてない場合はその者が押印している資格を表示する。

杉浦正知



1. 国際出願として提出された書類の実添の受理の日

受理官庁記入欄

2. 図面

 受理された

3. 国際出願として提出された書類を補完する書類又は図面であって

その後期間内に提出されたものの実添の受理の日(訂正日)

4. 特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期間内の受理の日

 不足図面がある5. 出願人により特定された
国際調査機関

ISA/

6. 調査手数料未払いにつき、国際調査機関に
調査用写しを送付していない

国際調査機関記入欄

記録原本の受理の日

THIS PAGE BLANK (USPTO)

明 細 書

発明の名称

オーミック電極形成用積層体およびオーミック電極

技術分野

5 この発明は、オーミック電極形成用積層体およびオーミック電極に
関し、特に、III-V族化合物半導体に対するオーミック電極に適用し
て好適なものである。

背景技術

10 化合物半導体を用いたFETなどのデバイスの高性能化や信頼性の
向上を図る上で、オーミック電極の接触抵抗の低減や熱安定性の向上
は重要な課題である。しかしながら、化合物半導体、特にGaAs系
半導体などのIII-V族化合物半導体に対するオーミック電極は、上記
の要求を満足するものが得られていないのが現状である。

15 現在、GaAs系半導体に対するオーミック電極の材料として最も
よく用いられているものは、AuGe/Niである。このAuGe/
Niをオーミック電極の材料として用いた場合には、400~500
°Cの熱処理により、GaAs系半導体とオーミック接触するオーミック
電極を形成することができる。

20 このようにAuGe/Niをオーミック電極の材料として用いる場合の最も大きな問題は、この材料を用いて形成されるオーミック電極
の熱安定性が悪いことである。すなわち、AuGe/Ni中にAuが
多量に含まれている（通常用いられるAuGe中には88%のAuが
含まれている）ことにより、400°C以上の温度でGaAsとAuと
が反応して β -AuGa（六方最密（HCP）構造で融点 $T_m = 375^{\circ}\text{C}$ ）が形成されるため、オーミック電極の接触抵抗は低下するもの
の、熱安定性は劣化する。その結果、オーミック電極形成後に行われ

THIS PAGE BLANK (USPTO)

る化学気相成長（CVD）などの高温プロセスによりデバイス特性の劣化が引き起こされる。

この問題を第1図に示すGaAs JFETの製造プロセスを例にとって具体的に説明すると、次のようになる。すなわち、この製造プロセスでは、まず、第1図Aに示すように、半絶縁性GaAs基板101中に、n型不純物の選択的なイオン注入およびその後の熱処理によりn型チャネル層102を形成する。次に、半絶縁性GaAs基板101の全面にSi₃N₄膜のような絶縁膜103を形成した後、この絶縁膜103の所定部分をエッチング除去して開口103aを形成する。この後、この開口103aを通じてn型チャネル層102中にp型不純物としてZnを拡散させることによりp⁺型ゲート領域104を形成する。次に、ゲート電極材料として全面に例えればTi/Pt/Au膜を形成した後、その上にゲート電極に対応する形状のレジストパターン（図示せず）を形成し、このレジストパターンをマスクとしてTi/Pt/Au膜をイオンミリング法によりパターニングする。これによって、第1図Bに示すように、ゲート電極105が形成される。次に、絶縁膜103の所定部分をエッチング除去して開口103b、103cを形成した後、これらの開口103b、103cの部分におけるn型チャネル層102上に、AuGe/Niを材料として用いてそれぞれソース電極およびドレイン電極としてのオーミック電極106、107を形成する。次に、第1図Cに示すように、それぞれオーミック電極106、107と接続された一層目の配線108、109を形成する。次に、第1図Dに示すように、後述の二層目の配線との電気的絶縁のための例えはSi₃N₄膜のような層間絶縁膜110をCVD法により全面に形成した後、この層間絶縁膜110の所定部分をエッチング除去して開口110a、110bを形成する。ここ

THIS PAGE BLANK (USPTO)

で、この層間絶縁膜 110 を CVD 法により形成する際に 400 °C 近い高温プロセスを経るため、デバイス特性の劣化が生じるのである。二層目の配線を形成するには、二層目の配線のコンタクト部などを除いた部分の表面に例えればレジスト 111 を形成する。次に、全面に二層目の配線形成用の材料を形成した後、レジスト 111 を除去する。
5 これによって、第 1 図 E に示すように、二層目の配線 112、113 がエアーブリッジ配線として形成される。

上述のようにオーミック電極の材料として AuGe/Ni を用いた場合には、上記の問題のほかに、GaAs と Au との反応により β -AuGa が形成されることにより、オーミック電極の表面の面荒れが生じ、これが後の微細加工を行う上で大きな問題となっている。
10

これらの問題を解決するため、これまでに種々のオーミック電極材料の研究が行われている。ところで、オーミック接触を考えた場合、最も理想的とされるのは、第 2 図に示すように、電極金属との界面におけるエネルギー障壁を低下させ、上述の β -AuGa のような低融点の化合物を含まない金属でオーミック接触を得ることである。なお、第 2 図において、 E_c および E_v はそれぞれ伝導帯の下端のエネルギーおよび価電子帯の上端のエネルギー、 E_F はフェルミエネルギーを示す。この図 2 に示す構造のオーミック電極は、有機金属化学気相成長 (MOCVD) 法などのエピタキシャル成長法により GaAs 基板上に $In_x Ga_{1-x} As$ 層を低エネルギー障壁の中間層として形成し、その上に電極金属を形成することにより得られている。しかしながら、このような構造のオーミック電極を得るために MOCVD 装置などのエピタキシャル成長装置を用いることは、プロセスウインドウを小さくし、また、量産性も悪くする。
15
20
25

このような問題を解決するために、低エネルギー障壁の中間層とし

THIS PAGE BLANK (USPTO)

ての InAs 層を InAs をターゲットとして用いたスパッタリング法により形成するとともに、W 薄膜および Ni 薄膜は電子ビーム蒸着法を用いて形成して、InAs/W 構造、InAs/Ni/W 構造、
5 Ni/InAs/Ni/W 構造などの積層体を GaAs 基板上に形成し、その後に熱処理を行うことにより、熱安定性が良好なオーミック電極を形成することができるところが報告されている (J. Appl. Phys. 68, 2475(1990))。第 3 図はその一例を示し、n 型 GaAs 基板 20
0 上にスパッタリング法により InAs 層 201 を形成し、さらにこの InAs 層 201 上に Ni 薄膜 202 および W 薄膜 203 を順次形成した後、熱処理を行うことによりオーミック電極を形成する。
10

この方法は、InAs 層 201 の形成に高速で成膜を行うことができるスパッタリング法を用いているので、非常に量産性に優れている。また、このオーミック電極は、その最上層に高融点金属である W 薄膜 203 を用いていることから、このオーミック電極に接続する金属配線の材料として Al、Au といったあらゆる金属をバリアメタルを用いることなく利用することができるなど、プロセスの自由度も大きい。
15 しかしながら、この方法では、熱処理時に微量の In が W 薄膜 203 上に拡散することにより、十分に低い接触抵抗を得ることができないという大きな問題を有している。また、熱処理時に In が W 薄膜 20
20 3 上に拡散する結果、オーミック電極の表面が荒れ、モフォロジーが極めて悪くなるという問題もある。

近年、このオーミック電極の表面モフォロジーの問題を解決するために、InAs/Ni/WSi/W 構造の積層体を GaAs 基板上に形成し、その後熱処理を行うことによりオーミック電極を形成する方法が本出願人により提案されている (特開平 7-94444 号公報)。
25 しかしながら、この方法により形成されるオーミック電極は、Au/G

THIS PAGE BLANK (USPTO)

e/Niを用いて形成される従来のオーミック電極と比べて接触抵抗が高いという問題がある。また、オーミック電極を形成するために必要な熱処理の温度も700～800°C程度と高いことから、この熱処理の際に不純物の拡散が起きやすく、不純物の再分布が引き起こされるという問題がある。これは、例えば、バイポーラトランジスタのように狭い領域に高不純物濃度のベース層を形成するときに問題となる。

上述のように、従来のGaAs系半導体に対するオーミック電極はいずれも不満足なものであるため、実用上満足しうる特性を有するオーミック電極の実現が望まれていた。

10 発明の開示

従って、この発明の目的は、GaAs系半導体その他のIII-V族化合物半導体に対する、実用的に満足しうる特性を有するオーミック電極を容易に形成することができるオーミック電極形成用積層体およびそれを用いて得られるオーミック電極を提供することにある。

15 この発明によるオーミック電極形成用積層体は、

III-V族化合物半導体基体上に順次形成された、非単結晶半導体層および少なくとも窒化金属薄膜を含む薄膜から成ることを特徴とするものである。

また、この発明によるオーミック電極形成用積層体は、

20 III-V族化合物半導体基体上に順次形成された、非単結晶半導体層および少なくとも窒化金属薄膜を含む薄膜であって、非単結晶半導体層と薄膜との間のエネルギー障壁の高さはIII-V族化合物半導体基体と薄膜との間のエネルギー障壁の高さよりも低いものから成ることを特徴とするものである。

25 この発明によるオーミック電極は、

III-V族化合物半導体基体上に順次形成された、非単結晶半導体層

THIS PAGE BLANK (USPTO)

および少なくとも窒化金属薄膜を含む薄膜から成るオーミック電極形成用積層体を熱処理することによって得られることを特徴とするものである。

また、この発明によるオーミック電極は、

5 III-V族化合物半導体基体上に形成されたオーミック電極であって、
非単結晶半導体層および少なくとも窒化金属薄膜を含む薄膜を有し、
上記非単結晶半導体層と上記薄膜との間のエネルギー障壁の高さは上
記III-V族化合物半導体基体と上記薄膜との間のエネルギー障壁の高
さよりも低いものから成るオーミック電極形成用積層体を熱処理する
10 ことによって得られることを特徴とするものである。

この発明において、III-V族化合物半導体基体には、例えばG a A
s、A l G a A s、I n G a A sなどから成る基板または層が含まれ
る。また、このIII-V族化合物半導体基体がn型である場合、このII
I-V族化合物半導体基体中にはドナーとなる不純物として、例えばS
15 i、G e、T e、S nなどが含まれる。これらのドナーとなる不純物
は、例えばイオン注入、液相エピタキシー（L P E）、分子線エピタ
キシー（M B E）、有機金属気相エピタキシー（M O V P E）などの
方法によりIII-V族化合物半導体基体中に導入される。

非単結晶半導体層には非単結晶I_n_xG a_{1-x}A s層（ただし、0
20 < x ≤ 1）などが含まれる。ここで、「非単結晶」とは、単結晶では
なく、多結晶または非晶質であることを意味する。この非単結晶半導
体層は、好適には、スパッタリング法により形成されるが、他の方法、
例えば真空蒸着法、特に電子ビーム蒸着法によって形成してもよい。
この非単結晶半導体層をスパッタリング法により形成する場合には、
25 ターゲットとしてこの非単結晶半導体層と同一の半導体材料から成る
单一のターゲットを用いた通常のスパッタリング法を用いることがで

THIS PAGE BLANK (USPTO)

きるほか、この非単結晶半導体層の各構成元素から成る複数のターゲットを用いた同時スパッタリング法を用いることもできる。

III-V族化合物半導体基体と非単結晶半導体層との間には、非単結晶半導体層のIII-V族化合物半導体基体に対する濡れ性を向上させるためなどの目的で、例えばNi薄膜のような金属薄膜を形成してもよい。

この発明の典型的な一実施形態においては、非単結晶半導体層上の薄膜は、金属薄膜およびこの金属薄膜上に形成された窒化金属薄膜を有する。この場合、金属薄膜は、より低い温度での熱処理により低い接触抵抗のオーム電極を形成することができるようにするためなどの理由により用いられる。また、窒化金属薄膜は、熱処理時に非単結晶半導体層の構成元素、例えばInが電極表面側に拡散するのを防止するために用いられる。この窒化金属薄膜上には、オーム電極のシート抵抗の低減を図るためや、バリアメタルを用いることなくオーム電極に金属配線を接続することができるようにするためなどの理由により、好適には、窒化金属薄膜に比べて抵抗率が低く、しかも配線に用いられる材料との反応が起こりにくい高融点金属薄膜が形成される。ここで、金属薄膜としては、Ni薄膜、Al薄膜、Co薄膜などを用いることができる。また、窒化金属薄膜としては、WN薄膜、WSiN薄膜、Ta_N薄膜、TaSiN薄膜、Ti_N薄膜、TiSiN薄膜、Ti_{ON}薄膜などを用いることができる。これらの窒化金属薄膜は、結晶質（多結晶など）であっても非晶質であってもよい。さらに、高融点金属薄膜としては、W薄膜、Mo薄膜、Ta薄膜などを用いることができる。

上記の高融点金属薄膜上には、オーム電極のシート抵抗の低減を図り、このオーム電極を配線としても用いることができるよう

THIS PAGE BLANK (USPTO)

にするために、配線用金属薄膜、例えばAl薄膜、Al合金（Al-Si、Al-Cu、Al-Si-Cuなど）薄膜、Au薄膜、Au/Ti薄膜などを形成してもよい。

5 非単結晶半導体層上の薄膜、すなわち金属薄膜、窒化金属薄膜、高融点金属薄膜などは、スパッタリング法や、真空蒸着法、特に電子ビーム蒸着法によって形成することができる。これらの金属薄膜、窒化金属薄膜、高融点金属薄膜などをスパッタリング法により形成する場合には、ターゲットとしてこれらと同一の材料から成る单一のターゲットを用いた通常のスパッタリング法を用いることができるほか、これら10の各構成元素から成る複数のターゲットを用いた同時スパッタリング法を用いることもできる。また、これらの金属薄膜、窒化金属薄膜、高融点金属薄膜などを真空蒸着法により形成する場合には、これらと同一の材料から成る单一の蒸着源またはこれらの各構成元素から成る複数の蒸着源を用いることができる。さらに、高融点金属薄膜は、15場合によってはCVD法により形成してもよい。

この発明によれば、上述のオーミック電極形成用積層体をIII-V族化合物半導体基体上に形成した後、例えば500～600°C程度の温度で熱処理を行うことにより、実用上デバイスに要求される特性、すなわち熱安定性、低接触抵抗、表面の平坦性などの特性を満足するオ20ミック電極を容易に形成することができる。また、この場合、オミック電極の形成に必要な熱処理の温度は500～600°C程度と低いので、この熱処理の際に不純物の拡散が起きるのを防止することができ、不純物の再分布を防止することができる。

図面の簡単な説明

25 第1図はオーミック電極材料としてAuGe/Niを用いる従来のオーミック電極の形成方法をGaAs JFETの製造プロセスにお

THIS PAGE BLANK (USPTO)

けるオーミック電極の形成に用いた場合の問題点を説明するための断面図、第2図は理想的なオーミック電極のエネルギーバンド図、第3図は従来のオーミック電極の形成方法において用いられるInAs/Ni/W構造のオーミック電極形成用積層体を示す断面図、第4図はこの発明の第1の実施形態によるオーミック電極の形成方法を説明するための断面図、第5図はこの発明の第1の実施形態によるオーミック電極の形成方法により形成されたオーミック電極の接触抵抗の熱処理温度依存性の測定結果の一例を示すグラフ、第6図はこの発明の第1の実施形態によるオーミック電極の形成方法においてオーミック電極形成用積層体を形成した後に550°Cで1秒間熱処理を行うことによりオーミック電極を形成し、さらに400°Cで10時間熱処理を行った後のオーミック電極の表面を撮影した光学顕微鏡写真、第7図はこの発明の第1の実施形態によるオーミック電極の形成方法により形成されたオーミック電極の熱安定性の測定結果の一例を示すグラフ、第8図はこの発明の第2の実施形態によるオーミック電極の形成方法において用いられるオーミック電極形成用積層体を示す断面図、第9図はこの発明の第3の実施形態によるオーミック電極の形成方法において用いられるオーミック電極形成用積層体を示す断面図、第10図はこの発明の第4の実施形態によるGaAs MESFETの製造方法を説明するための断面図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、この発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、実施形態の全図において、同一または対応する部分には同一の符号を付す。

第4図はこの発明の第1の実施形態によるオーミック電極の形成方法を示す。

THIS PAGE BLANK (USPTO)

この第1の実施形態においては、まず、第4図Aに示すように、 n^+ 型GaAs基板1'上にフォトレジストを塗布した後、このフォトレジストをフォトリソグラフィー法によりパターニングし、形成すべきオーム電極に対応する部分に開口を有するレジストパターン2を形成する。このレジストパターン2の厚さは、後述の非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、Ni薄膜4、WN薄膜5およびW薄膜6の合計の厚さよりも十分に大きくなるように選ばれる。また、このフォトリソグラフィーにおける露光は、例えば縮小投影露光装置（いわゆるステッパー）のような光学式露光装置を用いて行われる。なお、このレジストパターン2の形成は、電子線レジストと電子ビームリソグラフィー法とを用いて行うようにしてもよい。

次に、第4図Bに示すように、まず、例えばIn_{0.7}Ga_{0.3}Asをターゲットとして用いたスパッタリング法（例えば、マグнетロンスパッタリング法）により非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3を全面に形成し、引き続いて例えばスパッタリング法や電子ビーム蒸着法によりNi薄膜4、WN薄膜5およびW薄膜6を順次全面に形成する。ここで、スパッタリング法、例えばマグネットロൺスパッタリング法により非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3を形成する場合には、成膜室内を例えばベース圧力 2×10^{-5} Paに真空排気した後、この成膜室内にArガスを例えば圧力 3×10^{-1} Paまで導入し、このArガスをDC放電させる。この場合の使用電力は、例えば150Wである。また、成膜は例えば室温で行われる。このとき、成膜速度は例えば7nm/分である。さらにまた、スパッタリング法、例えばマグネットロൺスパッタリング法によりWN薄膜5を形成する場合には、成膜室内を例えばベース圧力 2×10^{-5} Paに真空排気した後、この成膜室内にN₂ガスを例えば圧力 3×10^{-1} Paまで導入し、このN₂ガスを

THIS PAGE BLANK (USPTO)

D C放電させる。この場合の使用電力は例えば150Wであり、成膜は例えば室温で行われる。なお、N₂ガスの代わりにN₂ガスとA rガスとの混合ガスを用いてもよい。また、上に挙げたスパッタリング法はいわゆるD Cスパッタリング法であるが、場合によっては、この
5 D Cスパッタリング法の代わりにR Fスパッタリング法を用いてもよい。

次に、上述のようにして非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、Ni薄膜4、WN薄膜5およびW薄膜6が形成されたn⁺型GaAs基板1を例えればアセトンのような有機溶剤に浸けてレジストパターン2を溶解除去することにより、このレジストパターン2上に形成された非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、Ni薄膜4、WN薄膜5およびW薄膜6を除去する。この結果、第4図Cに示すように、レジストパターン2の開口部に対応する部分におけるn⁺型GaAs基板1上にのみ非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、Ni薄膜4、WN薄膜5およびW薄膜6が残される。
10
15

次に、これらの非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、Ni薄膜4、WN薄膜5およびW薄膜6、すなわちオーミック電極形成用積層体が形成されたn⁺型GaAs基板1を、例えばRTA(Rapid Thermal Annealing)法や一般的な電気炉による方法により例えば500～60
20 0°Cで短時間、例えば1秒～数分間の熱処理を行う。この熱処理の際の雰囲気としては、例えばN₂ガスや、微量のH₂ガスを添加したN₂ガスから成る雰囲気を用いる。この熱処理の結果、第4図Dに示すように、オーミック電極7が形成される。

第5図は、この第1の実施形態による方法により形成されたオーミック電極7の接触抵抗の熱処理温度依存性の測定結果の一例を示す。
25 測定に用いた試料は、非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、WN薄膜

THIS PAGE BLANK (USPTO)

5 およびW薄膜6の厚さをそれぞれ14nm、25nmおよび50nmに固定し、Ni薄膜4の厚さを9nm、10nmおよび11nmの3水準に変え、これらの非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、Ni薄膜4、WN薄膜5およびW薄膜6をn⁺型GaAs基板1上に形成した後、RTA法により450～655°Cの範囲で温度を変えて1秒間熱処理を行うことによりオーム電極を形成したものである。ただし、これらの熱処理の際の雰囲気としては、5%のH₂ガスが添加されたN₂ガス雰囲気を用いた。また、n⁺型GaAs基板1としては、(100)面方位の半絶縁性GaAs基板にSiをイオン注入してn型化した、不純物濃度が2×10¹⁸cm⁻³のものを用いた。接触抵抗の測定はTLM(Transmission Line Method)法により行った。第5図より、熱処理温度が550°Cのときに接触抵抗は最も低くなり、約0.2Ωmmと極めて低い接触抵抗値が得られていることがわかる。

第6図は、非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、Ni薄膜4、WN薄膜5およびW薄膜6から成るオーム電極形成用積層体をn⁺型GaAs基板1上に形成した後、RTA法により550°Cで1秒間熱処理を行ってオーム電極7を形成し、さらに400°Cで10時間熱処理を行った後のオーム電極7の表面を撮影した光学顕微鏡写真を示す。ただし、非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、Ni薄膜4、WN薄膜5およびW薄膜6の厚さはそれぞれ14nm、10nm、25nmおよび25nmである。第6図より、400°Cで10時間熱処理を行った後の状態におけるオーム電極7の表面モフォロジーは極めて良好であることのみならず、熱安定性に関しても極めて良好であることがわかる。このように良好な表面モフォロジーが得られる理由は、オーム電極形成用積層体におけるWN薄膜5の存在により、熱処理時に非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3からInが電極表面側

THIS PAGE BLANK (USPTO)

に拡散するのが防止されるためである。

また、オーミック電極7を形成した後に試料を400°Cで10時間熱処理したときのこのオーミック電極7の接触抵抗の経時変化、すなわちオーミック電極7の熱安定性を測定したところ、第7図に示すような結果が得られた。ただし、非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、Ni薄膜4、WN薄膜5およびW薄膜6の厚さはそれぞれ25nm、10nm、25nmおよび50nmである。第7図においては、比較のために、WN薄膜を含まないオーミック電極形成用積層体を用いて形成したオーミック電極、具体的には厚さ25nmの非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層上に厚さ15nmのNi薄膜および厚さ50nmのW薄膜を形成したオーミック電極、および、厚さ23nmの非単結晶InAs層上に厚さ15nmのNi薄膜および厚さ50nmのW薄膜を形成したオーミック電極形成用積層体を用いて形成したオーミック電極の熱安定性の測定結果も示してある。

第7図より、厚さ25nmの非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層上に厚さ15nmのNi薄膜および厚さ50nmのW薄膜を形成したオーミック電極形成用積層体を用いて形成したオーミック電極の接触抵抗は、熱処理開始後1時間程度で増加し始めており、熱安定性が悪いことがわかる。また、厚さ23nmの非単結晶InAs層上に厚さ15nmのNi薄膜および厚さ50nmのW薄膜を形成したオーミック電極形成用積層体を用いて形成したオーミック電極の接触抵抗は、熱処理開始後10時間経過しても一定値を維持していて熱安定性は良好であるが、接触抵抗は0.45Ωmm程度とあまり低くはない。これに対し、WN薄膜を含むオーミック電極形成用積層体を用いて形成したこの第1の実施形態によるオーミック電極7の接触抵抗は、熱処理開

THIS PAGE BLANK (USPTO)

始後 10 時間経過しても一定値を維持していて熱安定性が良好である上に、接触抵抗も $0.2 \Omega \text{mm}$ 程度と極めて低い。ここで、このように良好な熱安定性が得られる理由は、オーミック電極 7 中には、AuGe/Ni を用いてオーミック電極を形成した場合にこのオーミック電極中に含まれる β -AuGa のような低融点の化合物が含まれていないため、および、WN 薄膜 5 により非単結晶 $In_{0.7}Ga_{0.3}As$ 層 3 から In が電極表面側に拡散するのが防止されるためである。

以上のように、この第 1 の実施形態によれば、 n^+ 型 GaAs 基板 1 上に、非単結晶 $In_{0.7}Ga_{0.3}As$ 層 3、Ni 薄膜 4、WN 薄膜 5 および W 薄膜 6 から成るオーミック電極形成用積層体を形成した後、例えば RTA 法により $500 \sim 600^\circ\text{C}$ の熱処理を例えれば 1 秒行うことにより、低接触抵抗かつ低膜抵抗で表面の平坦性あるいは表面モフオロジーも良好でさらに熱安定性も良好なオーミック電極 7 を容易に形成することができる。このオーミック電極 7 は、第 2 図に示す理想的なエネルギー-band 構造に近いエネルギー-band 構造を有する。このオーミック電極 7 はまた、その最上部が高融点金属である W から成るため、バリアメタルを用いることなく、金属配線を直接接続することができる。また、オーミック電極 7 の形成に用いられる非単結晶 $In_{0.7}Ga_{0.3}As$ 層 3 は、高速で成膜を行うことができるスパッタリング法により形成しているので、このオーミック電極 7 を高い生産性で形成することができる。そして、このオーミック電極 7 の接触抵抗は AuGe/Ni を用いて形成される従来のオーミック電極と同等の低い値であることから、このオーミック電極 7 を用いた半導体素子の特性を損なうこともない。さらに、オーミック電極 7 の形成に必要な熱処理の温度は $500 \sim 600^\circ\text{C}$ と低いので、この熱処理の際に不純物の拡散が起き、不純物の再分布が生じるのを有効に防止すること

THIS PAGE BLANK (USPTO)

ができる。

次に、この発明の第2の実施形態について説明する。

この第2の実施形態においては、第1の実施形態において用いた第4図Cに示すようなオーミック電極形成用積層体の代わりに、第8図に示すようなオーミック電極形成用積層体を用いる。この第8図に示すオーミック電極形成用積層体が第4図Cに示すオーミック電極形成用積層体と異なる点は、W薄膜6が形成されていないことである。その他のことは、第1の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

この第2の実施形態によつても、第1の実施形態とほぼ同様な良好な特性を有するオーミック電極を容易にしかも高い生産性で形成することができる。

次に、この発明の第3の実施形態について説明する。

この第3の実施形態においては、第1の実施形態において用いた第4図Cに示すようなオーミック電極形成用積層体の代わりに、第9図に示すようなオーミック電極形成用積層体を用いる。この第9図に示すオーミック電極形成用積層体が第4図Cに示すオーミック電極形成用積層体と異なる点は、W薄膜6上にさらにAl薄膜8が形成されていることである。

この第3の実施形態においては、第4図Bに示すと同様にW薄膜6まで形成した後、このW薄膜6上にAl薄膜8を例えばスパッタリング法や電子ビーム蒸着法により形成する。そして、その後、第1の実施形態で述べたと同様にしてリフトオフを行うことにより、オーミック電極形成部およびn⁺型GaAs基板1上に非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、Ni薄膜4、WN薄膜5、W薄膜6およびAl薄膜8から成るオーミック電極形成用積層体を形成する。この場合、リフトオフを行いややすくするために、リフトオフに用いるレジストパターン

THIS PAGE BLANK (USPTO)

を2層構造にして厚くし、さらにこのレジストパターンが例えばポジ型レジストからなる場合には、下層のレジストパターンに、より感光しやすいレジストを用いるなどの工夫をしてもよい。

この第3の実施形態によれば、オーミック電極形成用積層体の最上層にAl薄膜8が形成されていることにより、このオーミック電極形成用積層体を用いて形成されるオーミック電極7のシート抵抗の低減を図ることができる。これによって、このオーミック電極7をICの配線やキャパシタの電極として用いることができる。また、このため、配線工程が簡略され、設計の自由度が広がるという利点もある。

次に、この発明の第4の実施形態について説明する。

この第4の実施形態においては、GaAs MESFETの製造プロセスにおけるオーミック電極の形成に第2の実施形態によるオーミック電極の形成方法を用い、かつ、オーミック電極の形成と同時にゲート電極をも形成する場合について説明する。

すなわち、この第4の実施形態においては、まず、第10図Aに示すように、半絶縁性GaAs基板9のn型チャネル層形成部にドナーとなる不純物を低濃度に選択的にイオン注入するとともに、半絶縁性GaAs基板9のソース領域およびドレイン領域形成部にドナーとなる不純物を高濃度に選択的にイオン注入した後、例えば700～800°Cの温度で熱処理を行うことにより注入不純物を電気的に活性化してn型チャネル層10、n⁺型のソース領域11およびドレイン領域12を形成する。

次に、第10図Bに示すように、第1の実施形態で述べたと同様なリフトオフ法により、オーミック電極形成部に非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3およびNi薄膜4から成る積層体を形成する。

次に、例えばスパッタリング法により全面にWN薄膜を形成した後、

THIS PAGE BLANK (USPTO)

このWN薄膜上に、形成すべきゲート電極およびオーミック電極に対応した形状のレジストパターン（図示せず）をリソグラフィー法により形成し、このレジストパターンをマスクとしてWN薄膜を例えればC
5 F₄ / O₂ 系のエッチングガスを用いた反応性イオンエッチング（R I E）法によりエッチングする。その後、レジストパターンを除去する。これによって、第10図Cに示すように、オーミック電極形成部に非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、Ni薄膜4およびWN薄膜5から成るオーミック電極形成用積層体が形成されるとともに、n型チャネル層10上にWN薄膜から成るゲート電極13が形成される。なお、上記のWN薄膜を用いて配線を形成することも可能である。
10

次に、例えばRTA法により500～600℃の温度で熱処理を行う。これによって、第10図Dに示すように、第1の実施形態で述べたと同様にしてソース電極またはドレイン電極として用いられるオーミック電極14、15が形成され、目的とするGaAs MESFET
15 が完成される。

以上のように、この第4の実施形態によれば、ソース電極またはドレイン電極として用いて好適な良好な特性を有するオーミック電極14、15を容易に形成することができ、しかもこれらのオーミック電極14、15の形成に用いられるオーミック電極形成用積層体の形成時にゲート電極13を同時に形成することができる。これによって、
20 GaAs MESFETの製造工程の簡略化を図ることができる。

次に、この発明の第5の実施形態について説明する。

この第5の実施形態においては、n型III-V族化合物半導体に対するオーミック電極とp型III-V族化合物半導体に対するオーミック電極とを両方とも必要とする半導体素子を製造する場合に、これらのオーミック電極をこの発明によるオーミック電極形成用積層体を用いて
25

THIS PAGE BLANK (USPTO)

同時に形成する。

具体的には、例えば、G a A s J F E Tの製造において、半絶縁性G a A s基板中にp⁺型のゲート領域、n型のソース領域およびドレイン領域を形成した後、これらのゲート領域、ソース領域およびドレイン領域上にそれぞれ例えば第1の実施形態と同様なオーミック電極形成用積層体を形成し、その後例えば500～600℃の温度で熱処理を行うことにより、これらのゲート領域、ソース領域およびドレイン領域上にそれぞれのオーミック電極を同時に形成することができる。

また、III-V族化合物半導体を用いたヘテロ接合バイポーラトランジスタ（H B T）、例えば、エミッタ層にn型A l G a A s層を用い、ベース層にp型G a A s層を用い、コレクタ層にn型G a A s層を用い、これらのエミッタ層、ベース層およびコレクタ層に対するオーミック電極が必要なH B Tの製造において、これらのエミッタ層、ベース層およびコレクタ層上のオーミック電極形成部に例えば第1の実施形態と同様なオーミック電極形成用積層体を形成し、その後例えば500～600℃の温度で熱処理を行うことにより、これらのエミッタ層、ベース層およびコレクタ層上にそれぞれのオーミック電極を同時に形成することができる。

以上、この発明の実施形態につき具体的に説明したが、この発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。

例えば、上述の第1の実施形態～第4の実施形態において用いられたN i薄膜4の代わりに、C o薄膜またはA l薄膜を用いてもよい。

また、上述の第1の実施形態～第3の実施形態においては、オーミック電極形成用積層体をリフトオフ法により形成しているが、このオ

THIS PAGE BLANK (USPTO)

一ミック電極形成用積層体は、 n^+ 型G a A s基板1の全面にこのオーミック電極形成用積層体を構成する層をスパッタリング法などにより順次形成した後にこれらをエッチング法によりオーミック電極の形状にパターニングすることにより形成するようにしてもよい。

5 さらに、上述の第1の実施形態～第4の実施形態においては、G a A s基板に対するオーミック電極の形成にこの発明を適用した場合について説明したが、例えばエピタキシャル成長などにより形成されたG a A s層に対するオーミック電極の形成にこの発明を適用することも可能である。

10 また、この発明は、III-V族化合物半導体を用いた高電子移動度トランジスタ(HEMT)、例えばA l G a A s/G a A s H E M Tにおけるソース領域およびドレイン領域に対するオーミック電極の形成に適用することも可能である。

以上述べたように、この発明によれば、III-V族化合物半導体基体上に順次形成された、非単結晶半導体層および少なくとも窒化金属薄膜を含む薄膜から成るオーミック電極形成用積層体を熱処理することによって、III-V族化合物半導体に対する、実用的に満足しうる特性を有するオーミック電極を容易に形成することができる。

THIS PAGE BLANK (USPTO)

請求の範囲

1. III-V族化合物半導体基体上に順次形成された、非単結晶半導体層および少なくとも窒化金属薄膜を含む薄膜から成ることを特徴とするオーム電極形成用積層体。
- 5 2. 上記III-V族化合物半導体基体はGaAs、AlGaAsまたはInGaAsから成ることを特徴とする請求の範囲第1項記載のオーム電極形成用積層体。
- 10 3. 上記非単結晶半導体層は非単結晶 $In_x Ga_{1-x} As$ 層 ($0 < x \leq 1$) であることを特徴とする請求の範囲第1項記載のオーム電極形成用積層体。
4. 上記薄膜は金属薄膜および上記金属薄膜上に形成された窒化金属薄膜を有することを特徴とする請求の範囲第1項記載のオーム電極形成用積層体。
- 15 5. 上記窒化金属薄膜上にさらに高融点金属薄膜が形成されていることを特徴とする請求の範囲第4項記載のオーム電極形成用積層体。
6. 上記高融点金属薄膜上にさらに配線用金属薄膜が形成されていることを特徴とする請求の範囲第5項記載のオーム電極形成用積層体。
- 20 7. 上記金属薄膜はNi薄膜、Co薄膜またはAl薄膜であり、上記窒化金属薄膜はWN薄膜、WSiN薄膜、Ta_xN薄膜、TaSiN薄膜、TiN薄膜、TiSiN薄膜またはTiON薄膜であることを特徴とする請求の範囲第4項記載のオーム電極形成用積層体。
8. 上記高融点金属薄膜はW薄膜、Ta薄膜またはMo薄膜であることを特徴とする請求の範囲第5項記載のオーム電極形成用積層体。
- 25 9. III-V族化合物半導体基体上に順次形成された、非単結晶半導体層および少なくとも窒化金属薄膜を含む薄膜であって、上記非単結晶

THIS PAGE BLANK (USPTO)

半導体層と上記薄膜との間のエネルギー障壁の高さは上記III-V族化合物半導体基体と上記薄膜との間のエネルギー障壁の高さよりも低いものから成ることを特徴とするオーミック電極形成用積層体。

10. III-V族化合物半導体基体上に順次形成された、非単結晶半導体層および少なくとも窒化金属薄膜を含む薄膜から成るオーミック電極形成用積層体を熱処理することによって得られることを特徴とするオーミック電極。

11. 上記オーミック電極形成用積層体を熱処理する温度は500～600°Cであることを特徴とする請求の範囲第10項記載のオーミック電極。

12. 上記III-V族化合物半導体基体はGaAs、AlGaAsまたはInGaAsから成る上記オーミック電極形成用積層体を熱処理することによって得られることを特徴とする請求の範囲第10項記載のオーミック電極。

13. 上記非単結晶半導体層は非単結晶 $In_x Ga_{1-x} As$ 層 ($0 < x \leq 1$) である上記オーミック電極形成用積層体を熱処理することによって得られることを特徴とする請求の範囲第10項記載のオーミック電極。

14. 上記薄膜は金属薄膜および上記金属薄膜上に形成された窒化金属薄膜を有する上記オーミック電極形成用積層体を熱処理することによって得られることを特徴とする請求の範囲第10項記載のオーミック電極。

15. 上記窒化金属薄膜上にさらに高融点金属薄膜が形成されている上記オーミック電極形成用積層体を熱処理することによって得られるることを特徴とする請求の範囲第14項記載のオーミック電極。

16. 上記高融点金属薄膜上にさらに配線用金属薄膜が形成されてい

THIS PAGE BLANK (USPTO)

る上記オーミック電極形成用積層体を熱処理することによって得られることを特徴とする請求の範囲第15項記載のオーミック電極。

17. 上記金属薄膜はNi薄膜、Co薄膜またはAl薄膜であり、上記窒化金属薄膜はWN薄膜、WSiN薄膜、Ta_N薄膜、TaSiN薄膜、Ti_N薄膜、TiSiN薄膜またはTiON薄膜である上記オーミック電極形成用積層体を熱処理することによって得られることを特徴とする請求の範囲第14項記載のオーミック電極。

18. 上記高融点金属薄膜はW薄膜、Ta薄膜またはMo薄膜である上記オーミック電極形成用積層体を熱処理することによって得られることを特徴とする請求の範囲第15項記載のオーミック電極。

19. III-V族化合物半導体基体上に形成されたオーミック電極であって、

非単結晶半導体層および少なくとも窒化金属薄膜を含む薄膜を有し、上記非単結晶半導体層と上記薄膜との間のエネルギー障壁の高さは上記III-V族化合物半導体基体と上記薄膜との間のエネルギー障壁の高さよりも低いものから成るオーミック電極形成用積層体を熱処理することによって得られることを特徴とするオーミック電極。

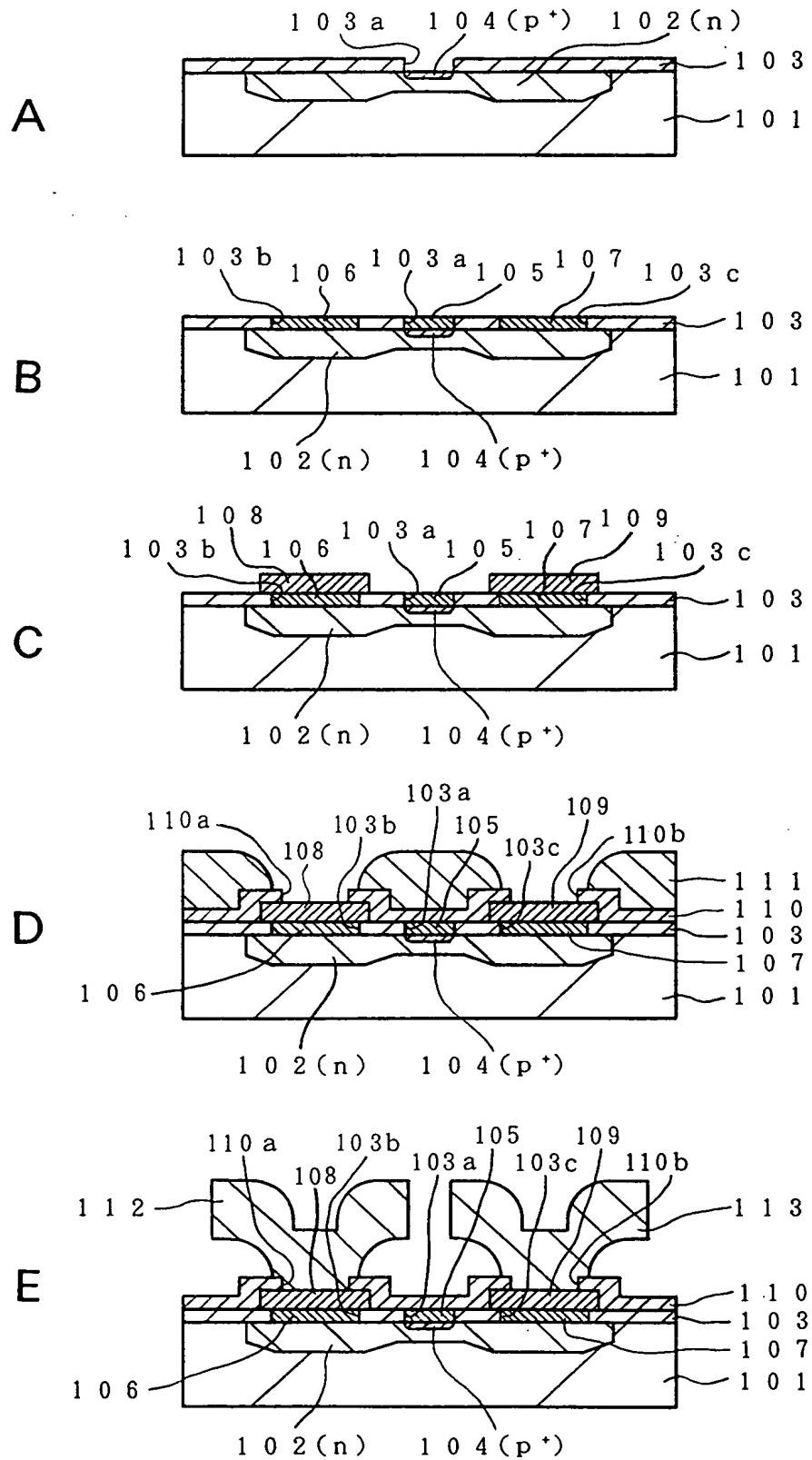
THIS PAGE BLANK (USPTO)

要 約 書

G a A s 系半導体などのIII-V族化合物半導体に対する実用的に満足しうる特性を有するオーミック電極を形成するためのオーミック電極形成用積層体およびそれを用いて得られるオーミック電極である。n⁺型G a A s 基板などのIII-V族化合物半導体基板上に、スパッタリング法などにより非単結晶I n_{0.7} G a_{0.3} A s 層のような非単結晶半導体層、N i 薄膜のような金属薄膜、W N 薄膜のような窒化金属薄膜およびW 薄膜のような高融点金属薄膜を順次形成し、これらをリフトオフなどによりパターニングしてオーミック電極形成用積層体を形成した後、例えばR T A法により500～600°C、例えば550°Cで1秒間熱処理を行うことによりオーミック電極を形成する。

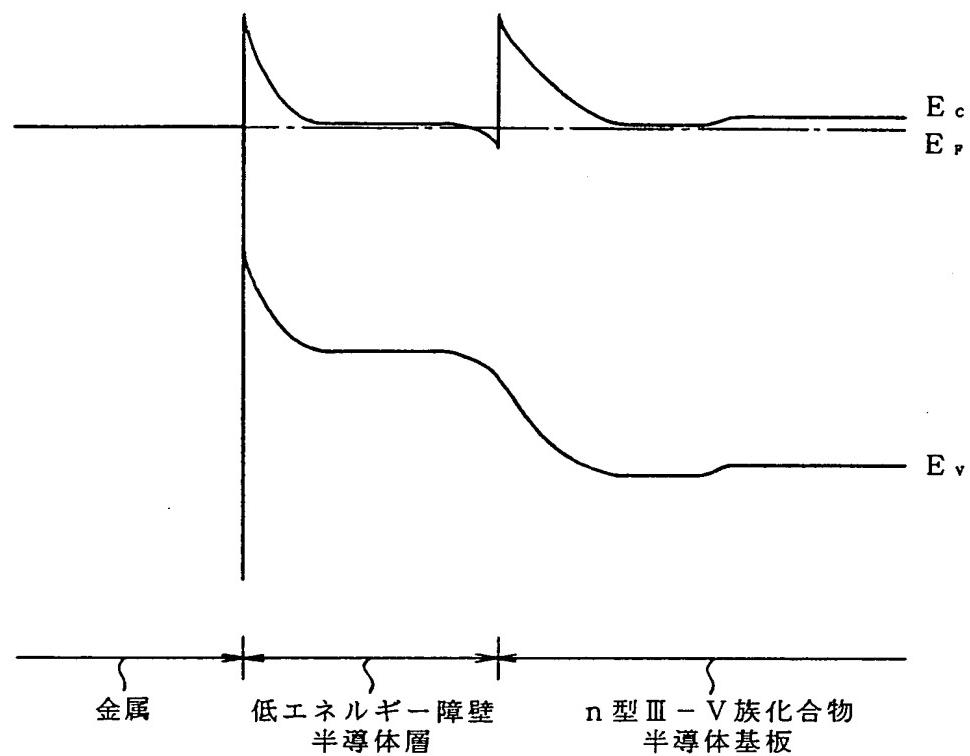
THIS PAGE BLANK (USPTO)

第1図

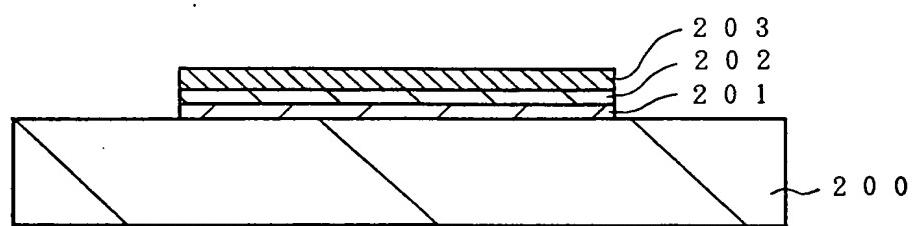


THIS PAGE BLANK (USPTO)

第2図

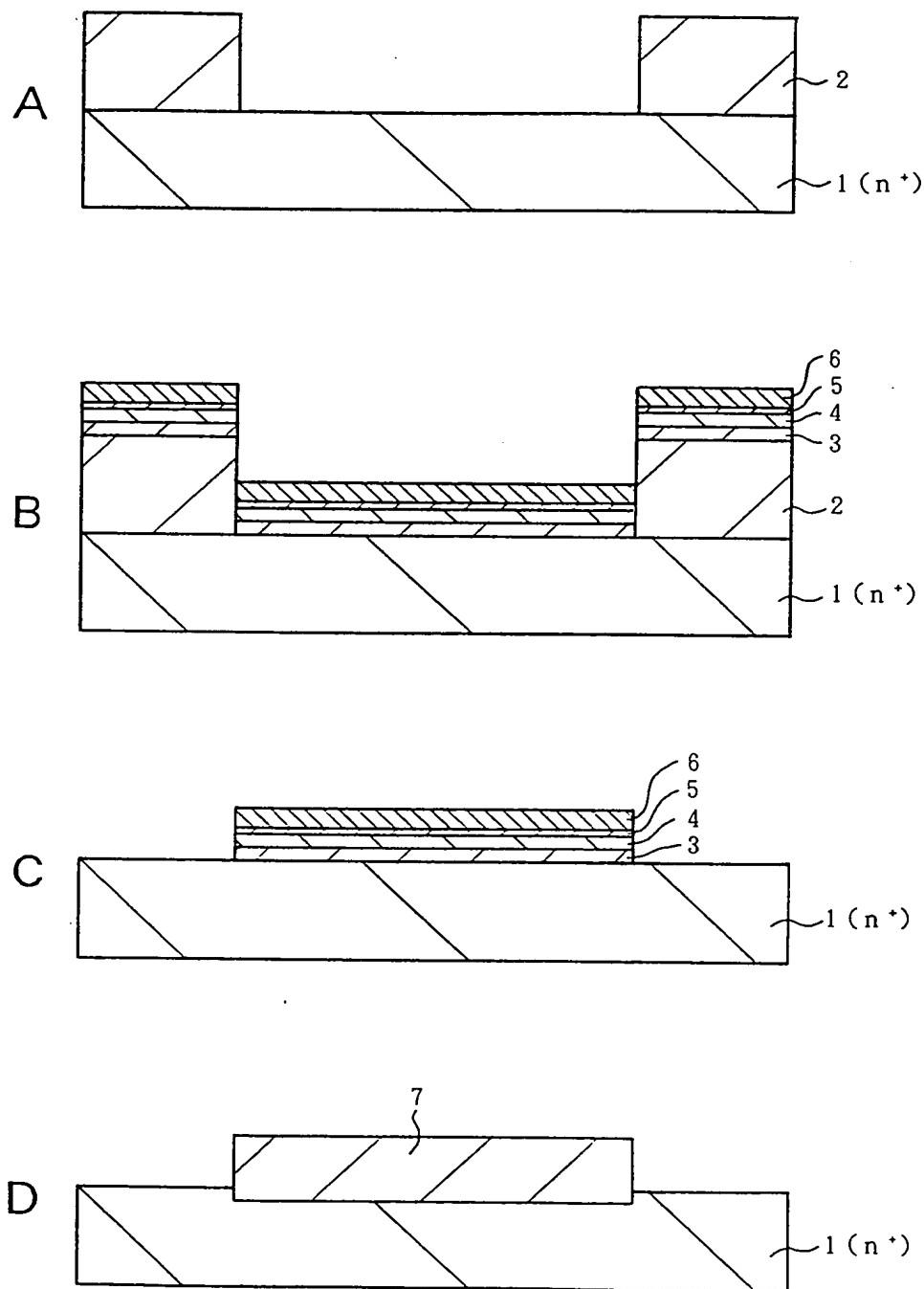


第3図



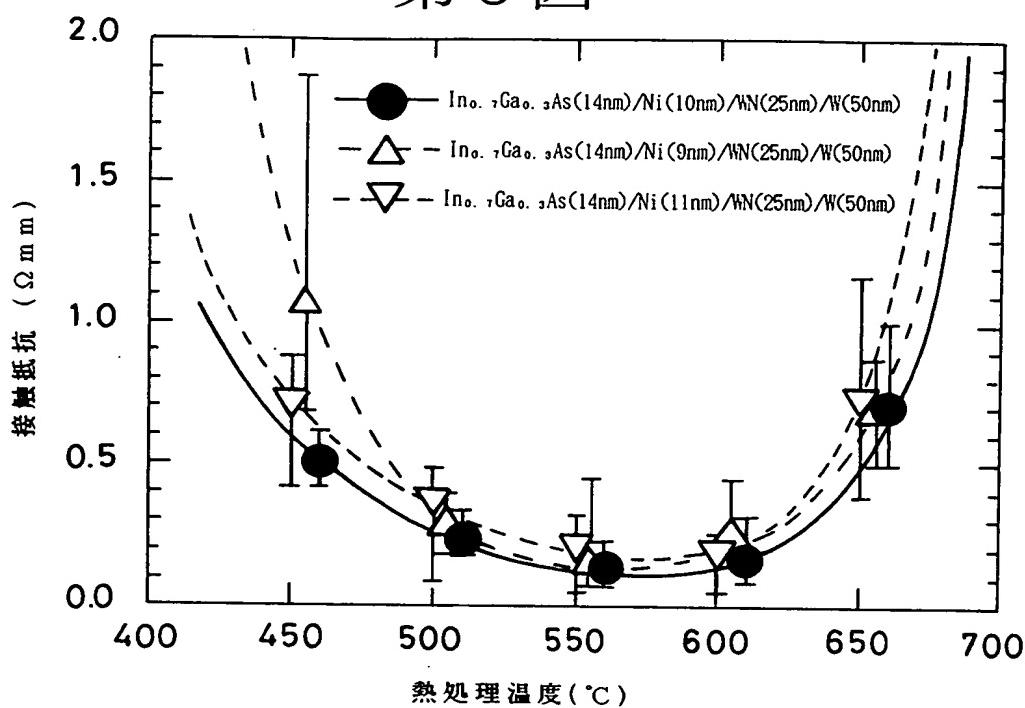
THIS PAGE BLANK (USPTO)

第4図

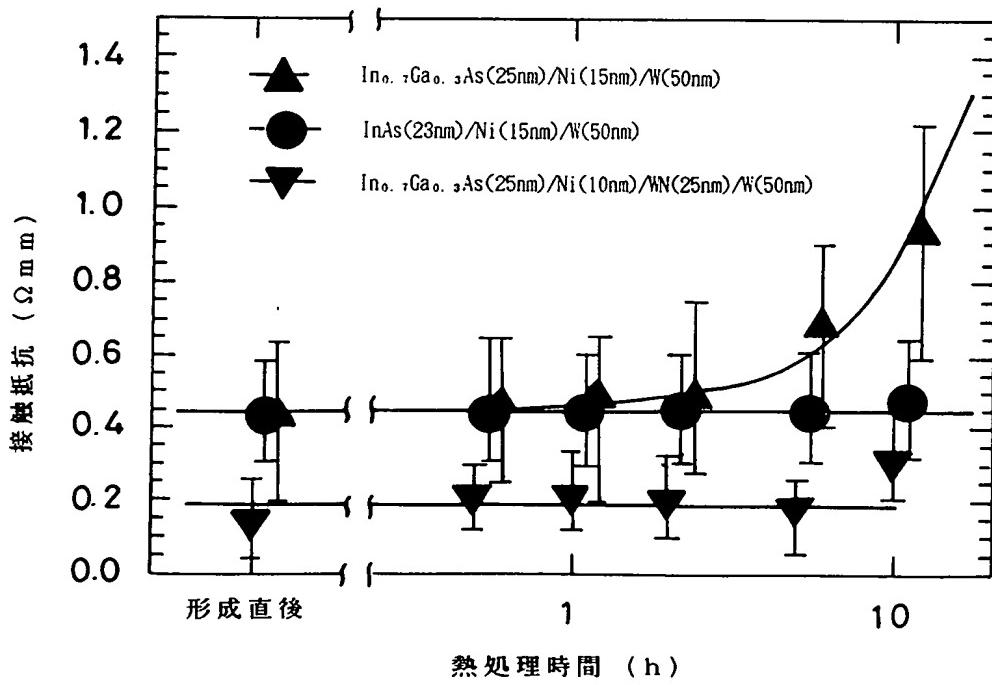


THIS PAGE BLANK (USPTO)

第5図

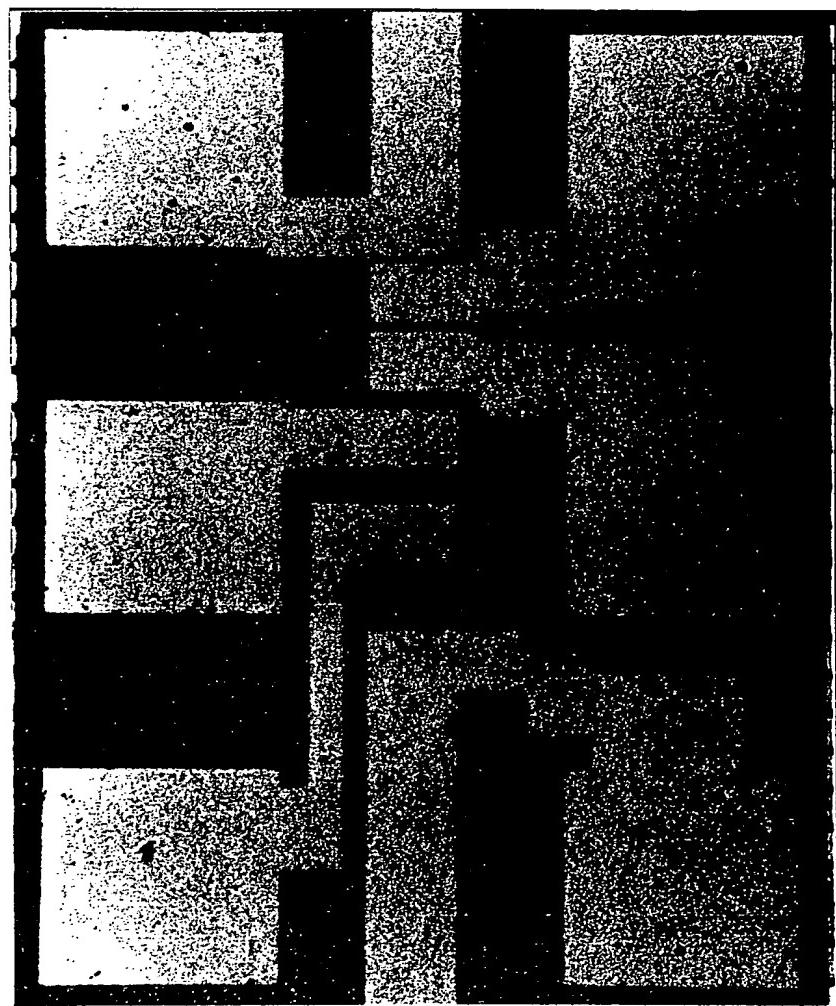


第7図



THIS PAGE BLANK (USPTO)

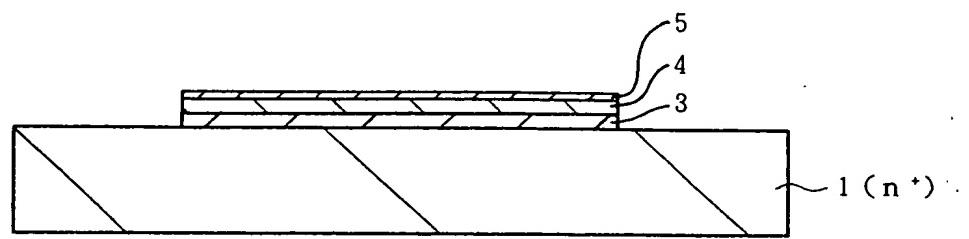
第 6 図



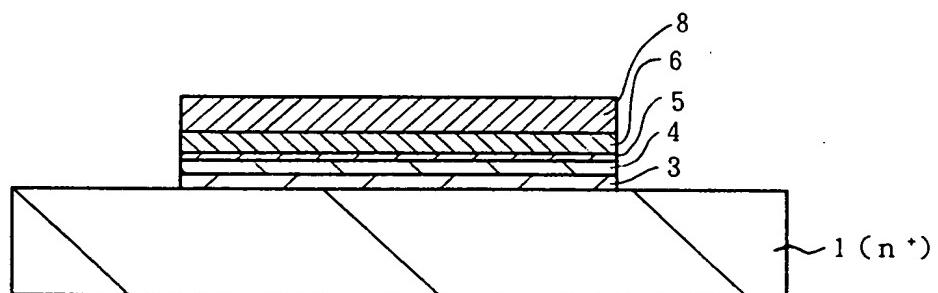
50 μm

THIS PAGE BLANK (USPTO)

第8図

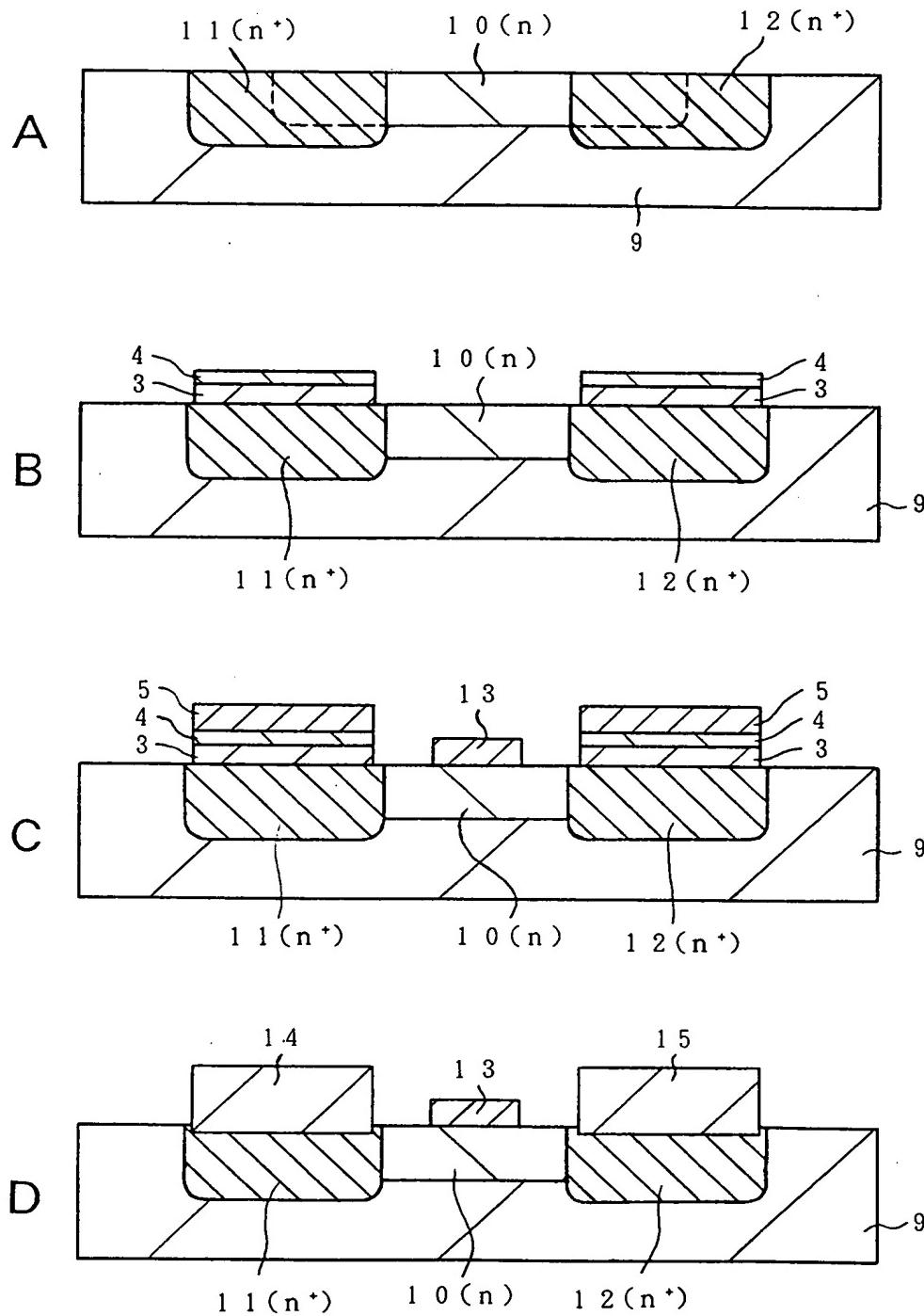


第9図



THIS PAGE BLANK (USPTO)

第10図



THIS PAGE BLANK (USPTO)

- 1 : n⁺ 型 G a A s 基板
3 : 非单結晶 I n_{0.7} G a_{0.3} A s 層
4 : N i 薄膜
5 : W N 薄膜
6 : W 薄膜
7 : オーミック電極
8 : A l 薄膜

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PCT

世界知的所有権機関
国際事務局
特許協力条約に基づいて公開された国際出願



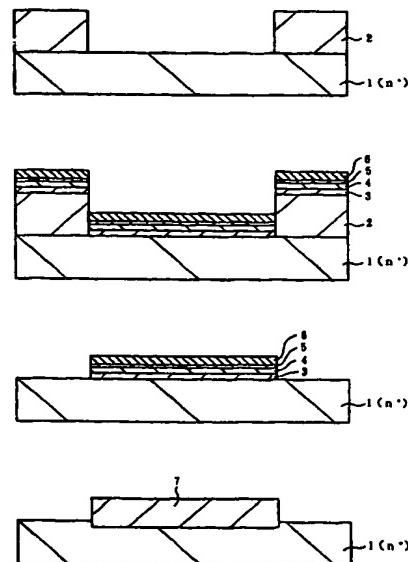
(51) 国際特許分類6 H01L 21/28	A1	(11) 国際公開番号 WO97/08744
		(43) 国際公開日 1997年3月6日(06.03.97)
(21) 国際出願番号 PCT/JP96/02318		(74) 代理人 弁理士 杉浦正知(SUGIURA, Masatomo) 〒170 東京都豊島区東池袋1丁目48番10号 25山京ビル420号 Tokyo, (JP)
(22) 国際出願日 1996年8月20日(20.08.96)		(81) 指定国 AU, BR, CA, CN, JP, KR, MX, SG, US, VN, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
(30) 優先権データ 特願平7/239120 1995年8月24日(24.08.95)	JP	(75) 添付公開書類 国際調査報告書
(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) ソニー株式会社(SONY CORPORATION)[JP/JP] 〒141 東京都品川区北品川6丁目7番35号 Tokyo, (JP)		
(72) 発明者 ; および (75) 発明者／出願人 (米国についてのみ) 中村光宏(NAKAMURA, Mitsuhiro)[JP/JP] 和田 勝(WADA, Masaru)[JP/JP] 〒141 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo, (JP)		
内堀千尋(UCHIBORI, Chihiro)[JP/JP] 村上正紀(MURAKAMI, Masanori)[JP/JP] 〒606 京都府京都市左京区吉田本町(番地なし) 京都大学工学部金属加工学教室内 Kyoto, (JP)		

(54)Title: LAMINATE FOR FORMING OHMIC ELECTRODE AND OHMIC ELECTRODE

(54)発明の名称 オーミック電極形成用積層体およびオーミック電極

(57) Abstract

A laminate for forming ohmic electrode having practically satisfactory properties for contact with a III-V compound semiconductor such as GaAs, and an ohmic electrode obtained by using this laminate. A semiconductor layer such as non-single-crystal $In_{0.7}Ga_{0.3}As$ layer, a thin metal film such as Ni, a thin metal nitride film such as Wn and a thin high-melting metal film such as W are successively formed on a III-V compound semiconductor substrate such as n^+ -type GaAs substrate by sputtering. These films are then patterned by lifting-off to form a laminate for forming ohmic electrode. Then, the laminate is heat-treated by, for example, the RTA method at 500 to 600 °C, e.g., at 550 °C for one second to form an ohmic electrode.



(57) 要約

GaAs系半導体などのIII-V族化合物半導体に対する実用的に満足しうる特性を有するオーム電極を形成するためのオーム電極形成用積層体およびそれを用いて得られるオーム電極である。

n⁺型GaAs基板などのIII-V族化合物半導体基板上に、スパッタリング法などにより非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層のような非単結晶半導体層、Ni薄膜のような金属薄膜、WN薄膜のような窒化金属薄膜およびW薄膜のような高融点金属薄膜を順次形成し、これらをリフトオフなどによりパターニングしてオーム電極形成用積層体を形成した後、例えばRTA法により500～600°C、例えば550°Cで1秒間熱処理を行うことによりオーム電極を形成する。

情報としての用途のみ

PCTに基づいて公開される国際出願をパンフレット第一頁にPCT加盟国を同定するために使用されるコード

AL	アルバニア	DE	ドイツ	LI	リヒテンシュタイン	PL	ポーランド
AM	アルメニア	DK	デンマーク	LC	セントルシア	PT	ポルトガル
AT	オーストリア	EE	エストニア	LK	スリランカ	RO	ルーマニア
AU	オーストラリア	ES	スペイン	LS	リベリア	RU	ロシア連邦
AZ	アゼルバイジャン	FI	フィンランド	LT	レソトニア	SDE	スードアン
BA	ボスニア・ヘルツェゴビナ	FR	フランス	LU	リトアニア	SE	スウェーデン
BB	バルバドス	GA	ガボン	LV	ラトヴィア	SG	シンガポール
BE	ベルギー	GB	イギリス	MC	モナコ	SI	スロヴェニア
BF	ブルキナ・ファソ	GE	グルジア	MD	モルドバ共和国	SK	スロ伐キア
BG	ブルガリア	GN	ギニア	MG	マダガスカル	SN	セネガル
BJ	ベナン	GR	ギリシャ	MK	マケドニア旧ユーゴスラ	SZ	スウェーデン
BR	ブラジル	HU	ハンガリー	ML	マリ	TD	チャド
BY	ベラルーシ	IE	アイルランド	MN	モンゴル	TG	トジキスタン
CA	カナダ	IL	イスラエル	MR	モーリタニア	TJ	トルクメニスタン
CF	中央アフリカ共和国	IS	アイスランド	MW	モラウイ	TR	トルコ
CG	コンゴ	IT	イタリア	MX	メキシコ	TT	トリニダード・トバゴ
CH	スイス	JP	日本	NE	ニジェール	TAG	ウクライナ
CI	コート・ジボアール	KE	ケニア	NO	オランダ	UG	ウガンダ
CM	カメルーン	KG	キルギスタン	NZ	ニューカaledonia	US	アメリカ合衆国
CN	中国	KP	朝鮮民主主義人民共和国			UZ	ウズベキスタン
CU	キューバ	KR	大韓民国			VN	ベトナム
CZ	チェコ共和国	KZ	カザフスタン				

明細書

発明の名称

オーミック電極形成用積層体およびオーミック電極

技術分野

5 この発明は、オーミック電極形成用積層体およびオーミック電極に
関し、特に、III-V族化合物半導体に対するオーミック電極に適用し
て好適なものである。

背景技術

化合物半導体を用いたFETなどのデバイスの高性能化や信頼性の
10 向上を図る上で、オーミック電極の接触抵抗の低減や熱安定性の向上
は重要な課題である。しかしながら、化合物半導体、特にGaAs系
半導体などのIII-V族化合物半導体に対するオーミック電極は、上記
の要求を満足するものが得られていないのが現状である。

現在、GaAs系半導体に対するオーミック電極の材料として最も
15 よく用いられているものは、AuGe/Niである。このAuGe/
Niをオーミック電極の材料として用いた場合には、400~500
°Cの熱処理により、GaAs系半導体とオーミック接触するオーミック
電極を形成することができる。

20 このようにAuGe/Niをオーミック電極の材料として用いる場合の最も大きな問題は、この材料を用いて形成されるオーミック電極
の熱安定性が悪いことである。すなわち、AuGe/Ni中にAuが
多量に含まれている（通常用いられるAuGe中には88%のAuが
含まれている）ことにより、400°C以上の温度でGaAsとAuと
が反応して β -AuGa（六方最密（HCP）構造で融点 $T_m = 375^{\circ}\text{C}$ ）が形成されるため、オーミック電極の接触抵抗は低下するもの
の、熱安定性は劣化する。その結果、オーミック電極形成後に行われ

る化学気相成長（CVD）などの高温プロセスによりデバイス特性の劣化が引き起こされる。

この問題を第1図に示すGaAs-JFETの製造プロセスを例にとって具体的に説明すると、次のようになる。すなわち、この製造プロセスでは、まず、第1図Aに示すように、半絶縁性GaAs基板101中に、n型不純物の選択的なイオン注入およびその後の熱処理によりn型チャネル層102を形成する。次に、半絶縁性GaAs基板101の全面にSi₃N₄膜のような絶縁膜103を形成した後、この絶縁膜103の所定部分をエッチング除去して開口103aを形成する。この後、この開口103aを通じてn型チャネル層102中にp型不純物としてZnを拡散させることによりp⁺型ゲート領域104を形成する。次に、ゲート電極材料として全面に例えばTi/Pt/Au膜を形成した後、その上にゲート電極に対応する形状のレジストパターン（図示せず）を形成し、このレジストパターンをマスクとしてTi/Pt/Au膜をイオンミリング法によりパターニングする。これによって、第1図Bに示すように、ゲート電極105が形成される。次に、絶縁膜103の所定部分をエッチング除去して開口103b、103cを形成した後、これらの開口103b、103cの部分におけるn型チャネル層102上に、AuGe/Niを材料として用いてそれぞれソース電極およびドレイン電極としてのオーム電極106、107を形成する。次に、第1図Cに示すように、それぞれオーム電極106、107と接続された一層目の配線108、109を形成する。次に、第1図Dに示すように、後述の二層目の配線との電気的絶縁のための例えばSi₃N₄膜のような層間絶縁膜110をCVD法により全面に形成した後、この層間絶縁膜110の所定部分をエッチング除去して開口110a、110bを形成する。ここ

で、この層間絶縁膜 110 を CVD 法により形成する際に 400 °C 近い高温プロセスを経るため、デバイス特性の劣化が生じるのである。二層目の配線を形成するには、二層目の配線のコンタクト部などを除いた部分の表面に例えばレジスト 111 を形成する。次に、全面に二層目の配線形成用の材料を形成した後、レジスト 111 を除去する。
5 これによって、第 1 図 E に示すように、二層目の配線 112、113 がエアーブリッジ配線として形成される。

上述のようにオームイック電極の材料として AuGe/Ni を用いた場合には、上記の問題のほかに、GaAs と Au との反応により β -AuGa が形成されることにより、オームイック電極の表面の面荒れが生じ、これが後の微細加工を行う上で大きな問題となっている。
10

これらの問題を解決するため、これまでに種々のオームイック電極材料の研究が行われている。ところで、オームイック接触を考えた場合、最も理想的とされるのは、第 2 図に示すように、電極金属との界面におけるエネルギー障壁を低下させ、上述の β -AuGa のような低融点の化合物を含まない金属でオームイック接触を得ることである。なお、第 2 図において、 E_c および E_v はそれぞれ伝導帯の下端のエネルギーおよび価電子帯の上端のエネルギー、 E_F はフェルミエネルギーを示す。この図 2 に示す構造のオームイック電極は、有機金属化学気相成長 (MOCVD) 法などのエピタキシャル成長法により GaAs 基板上に $In_x Ga_{1-x} As$ 層を低エネルギー障壁の中間層として形成し、その上に電極金属を形成することにより得られている。しかしながら、このような構造のオームイック電極を得るために MOCVD 装置などのエピタキシャル成長装置を用いることは、プロセスウィンドウを小さくし、また、量産性も悪くする。
20
25

このような問題を解決するために、低エネルギー障壁の中間層とし

ての InAs 層を InAs をターゲットとして用いたスパッタリング法により形成するとともに、W 薄膜および Ni 薄膜は電子ビーム蒸着法を用いて形成して、InAs/W 構造、InAs/Ni/W 構造、Ni/InAs/Ni/W 構造などの積層体を GaAs 基板上に形成し、その後に熱処理を行うことにより、熱安定性が良好なオーミック電極を形成することができるよう報告されている (J. Appl. Phys. 68, 2475(1990))。第 3 図はその一例を示し、n 型 GaAs 基板 200 上にスパッタリング法により InAs 層 201 を形成し、さらにこの InAs 層 201 上に Ni 薄膜 202 および W 薄膜 203 を順次形成した後、熱処理を行うことによりオーミック電極を形成する。

この方法は、InAs 層 201 の形成に高速で成膜を行うことができるスパッタリング法を用いているので、非常に量産性に優れている。また、このオーミック電極は、その最上層に高融点金属である W 薄膜 203 を用いていることから、このオーミック電極に接続する金属配線の材料として Al、Au といったあらゆる金属をバリアメタルを用いることなく利用することができるなど、プロセスの自由度も大きい。しかしながら、この方法では、熱処理時に微量の In が W 薄膜 203 上に拡散することにより、十分に低い接触抵抗を得ることができないという大きな問題を有している。また、熱処理時に In が W 薄膜 203 上に拡散する結果、オーミック電極の表面が荒れ、モフォロジーが極めて悪くなるという問題もある。

近年、このオーミック電極の表面モフォロジーの問題を解決するために、InAs/Ni/WSi/W 構造の積層体を GaAs 基板上に形成し、その後熱処理を行うことによりオーミック電極を形成する方法が本出願人により提案されている (特開平 7-94444 号公報)。しかしながら、この方法により形成されるオーミック電極は、Au/G

e / Ni を用いて形成される従来のオーム電極と比べて接触抵抗が高いという問題がある。また、オーム電極を形成するために必要な熱処理の温度も 700 ~ 800°C 程度と高いことから、この熱処理の際に不純物の拡散が起きやすく、不純物の再分布が引き起こされるという問題がある。これは、例えば、バイポーラトランジスタのように狭い領域に高不純物濃度のベース層を形成するときに問題となる。

上述のように、従来の GaAs 系半導体に対するオーム電極はいずれも不満足なものであるため、実用上満足しうる特性を有するオーム電極の実現が望まれていた。

10 発明の開示

従って、この発明の目的は、GaAs 系半導体その他の III-V 族化合物半導体に対する、実用的に満足しうる特性を有するオーム電極を容易に形成することができるオーム電極形成用積層体およびそれを用いて得られるオーム電極を提供することにある。

15 この発明によるオーム電極形成用積層体は、

III-V 族化合物半導体基体上に順次形成された、非単結晶半導体層および少なくとも窒化金属薄膜を含む薄膜から成ることを特徴とするものである。

また、この発明によるオーム電極形成用積層体は、

20 III-V 族化合物半導体基体上に順次形成された、非単結晶半導体層および少なくとも窒化金属薄膜を含む薄膜であって、非単結晶半導体層と薄膜との間のエネルギー障壁の高さは III-V 族化合物半導体基体と薄膜との間のエネルギー障壁の高さよりも低いものから成ることを特徴とするものである。

25 この発明によるオーム電極は、

III-V 族化合物半導体基体上に順次形成された、非単結晶半導体層

および少なくとも窒化金属薄膜を含む薄膜から成るオーミック電極形成用積層体を熱処理することによって得られることを特徴とするものである。

また、この発明によるオーミック電極は、

5 III-V族化合物半導体基体上に形成されたオーミック電極であって、
非単結晶半導体層および少なくとも窒化金属薄膜を含む薄膜を有し、
上記非単結晶半導体層と上記薄膜との間のエネルギー障壁の高さは上
記III-V族化合物半導体基体と上記薄膜との間のエネルギー障壁の高
さよりも低いものから成るオーミック電極形成用積層体を熱処理する
10 ことによって得られることを特徴とするものである。

この発明において、III-V族化合物半導体基体には、例えばGaAs、AlGaAs、InGaAsなどから成る基板または層が含まれる。また、このIII-V族化合物半導体基体がn型である場合、このII
I-V族化合物半導体基体中にはドナーとなる不純物として、例えばSi
15 15、Ge、Te、Snなどが含まれる。これらのドナーとなる不純物は、例えばイオン注入、液相エピタキシー（LPE）、分子線エピタキシー（MBE）、有機金属気相エピタキシー（MOVPE）などの方法によりIII-V族化合物半導体基体中に導入される。

非単結晶半導体層には非単結晶In_xGa_{1-x}As層（ただし、0
20 < x ≤ 1）などが含まれる。ここで、「非単結晶」とは、単結晶ではなく、多結晶または非晶質であることを意味する。この非単結晶半導体層は、好適には、スパッタリング法により形成されるが、他の方法、例えば真空蒸着法、特に電子ビーム蒸着法によって形成してもよい。
この非単結晶半導体層をスパッタリング法により形成する場合には、
25 ターゲットとしてこの非単結晶半導体層と同一の半導体材料から成る单一のターゲットを用いた通常のスパッタリング法を用いることがで

きるほか、この非単結晶半導体層の各構成元素から成る複数のターゲットを用いた同時スパッタリング法を用いることもできる。

III-V族化合物半導体基体と非単結晶半導体層との間には、非単結晶半導体層のIII-V族化合物半導体基体に対する濡れ性を向上させる
5ためなどの目的で、例えばNi薄膜のような金属薄膜を形成してもよい。

この発明の典型的な一実施形態においては、非単結晶半導体層上の薄膜は、金属薄膜およびこの金属薄膜上に形成された窒化金属薄膜を有する。この場合、金属薄膜は、より低い温度での熱処理により低い
10接触抵抗のオーム電極を形成することができるようにするためなどの理由により用いられる。また、窒化金属薄膜は、熱処理時に非単結晶半導体層の構成元素、例えばInが電極表面側に拡散するのを防止するために用いられる。この窒化金属薄膜上には、オーム電極のシート抵抗の低減を図るためや、バリアメタルを用いることなくオ
15ーム電極に金属配線を接続することができるようするためなどの理由により、好適には、窒化金属薄膜に比べて抵抗率が低く、しかも配線に用いられる材料との反応が起こりにくい高融点金属薄膜が形成される。ここで、金属薄膜としては、Ni薄膜、Al薄膜、Co薄膜などを用いることができる。また、窒化金属薄膜としては、WN薄膜、WSiN薄膜、Ta_N薄膜、TaSiN薄膜、Ti_N薄膜、Ti
20SiN薄膜、TiON薄膜などを用いることができる。これらの窒化金属薄膜は、結晶質（多結晶など）であっても非晶質であってもよい。さらに、高融点金属薄膜としては、W薄膜、Mo薄膜、Ta薄膜などを用いることができる。
25上記の高融点金属薄膜上には、オーム電極のシート抵抗の低減を図り、このオーム電極を配線としても用いることができるよう

にするために、配線用金属薄膜、例えばAl薄膜、Al合金（Al-Si、Al-Cu、Al-Si-Cuなど）薄膜、Au薄膜、Au/Ti薄膜などを形成してもよい。

5 非単結晶半導体層上の薄膜、すなわち金属薄膜、窒化金属薄膜、高融点金属薄膜などは、スパッタリング法や、真空蒸着法、特に電子ビーム蒸着法によって形成することができる。これらの金属薄膜、窒化金属薄膜、高融点金属薄膜などをスパッタリング法により形成する場合には、ターゲットとしてこれらと同一の材料から成る单一のターゲットを用いた通常のスパッタリング法を用いることができるほか、これら10 の各構成元素から成る複数のターゲットを用いた同時スパッタリング法を用いることもできる。また、これらの金属薄膜、窒化金属薄膜、高融点金属薄膜などを真空蒸着法により形成する場合には、これらと同一の材料から成る单一の蒸着源またはこれらの各構成元素から成る複数の蒸着源を用いることができる。さらに、高融点金属薄膜は、15 場合によってはCVD法により形成してもよい。

この発明によれば、上述のオーミック電極形成用積層体をIII-V族化合物半導体基体上に形成した後、例えば500～600°C程度の温度で熱処理を行うことにより、実用上デバイスに要求される特性、すなわち熱安定性、低接触抵抗、表面の平坦性などの特性を満足するオ20 ミック電極を容易に形成することができる。また、この場合、オミック電極の形成に必要な熱処理の温度は500～600°C程度と低いので、この熱処理の際に不純物の拡散が起きるのを防止することができ、不純物の再分布を防止することができる。

図面の簡単な説明

25 第1図はオーミック電極材料としてAuGe/Niを用いる従来のオーミック電極の形成方法をGaAs JFETの製造プロセスにお

けるオーミック電極の形成に用いた場合の問題点を説明するための断面図、第2図は理想的なオーミック電極のエネルギー-band図、第3図は従来のオーミック電極の形成方法において用いられるInAs/Ni/W構造のオーミック電極形成用積層体を示す断面図、第4図はこの発明の第1の実施形態によるオーミック電極の形成方法を説明するための断面図、第5図はこの発明の第1の実施形態によるオーミック電極の形成方法により形成されたオーミック電極の接触抵抗の熱処理温度依存性の測定結果の一例を示すグラフ、第6図はこの発明の第1の実施形態によるオーミック電極の形成方法においてオーミック電極形成用積層体を形成した後に550°Cで1秒間熱処理を行うことによりオーミック電極を形成し、さらに400°Cで10時間熱処理を行った後のオーミック電極の表面を撮影した光学顕微鏡写真、第7図はこの発明の第1の実施形態によるオーミック電極の形成方法により形成されたオーミック電極の熱安定性の測定結果の一例を示すグラフ、第8図はこの発明の第2の実施形態によるオーミック電極の形成方法において用いられるオーミック電極形成用積層体を示す断面図、第9図はこの発明の第3の実施形態によるオーミック電極の形成方法において用いられるオーミック電極形成用積層体を示す断面図、第10図はこの発明の第4の実施形態によるGaAs MESFETの製造方法を説明するための断面図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、この発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、実施形態の全図において、同一または対応する部分には同一の符号を付す。

第4図はこの発明の第1の実施形態によるオーミック電極の形成方法を示す。

この第1の実施形態においては、まず、第4図Aに示すように、 n^+ 型GaAs基板1上にフォトレジストを塗布した後、このフォトレジストをフォトリソグラフィー法によりパターニングし、形成すべきオーム式電極に対応する部分に開口を有するレジストパターン2を形成する。このレジストパターン2の厚さは、後述の非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、Ni薄膜4、WN薄膜5およびW薄膜6の合計の厚さよりも十分に大きくなるように選ばれる。また、このフォトリソグラフィーにおける露光は、例えば縮小投影露光装置（いわゆるステッパー）のような光学式露光装置を用いて行われる。なお、このレジストパターン2の形成は、電子線レジストと電子ビームリソグラフィー法とを用いて行うようにしてもよい。

次に、第4図Bに示すように、まず、例えばIn_{0.7}Ga_{0.3}Asをターゲットとして用いたスパッタリング法（例えば、マグネットロンスパッタリング法）により非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3を全面に形成し、引き続いて例えばスパッタリング法や電子ビーム蒸着法によりNi薄膜4、WN薄膜5およびW薄膜6を順次全面に形成する。ここで、スパッタリング法、例えばマグネットロンスパッタリング法により非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3を形成する場合には、成膜室内を例えばベース圧力 2×10^{-5} Paに真空排気した後、この成膜室内にArガスを例えば圧力 3×10^{-1} Paまで導入し、このArガスをDC放電させる。この場合の使用電力は、例えば150Wである。また、成膜は例えば室温で行われる。このとき、成膜速度は例えば7nm/分である。さらにまた、スパッタリング法、例えばマグネットロンスパッタリング法によりWN薄膜5を形成する場合には、成膜室内を例えばベース圧力 2×10^{-5} Paに真空排気した後、この成膜室内にN₂ガスを例えば圧力 3×10^{-1} Paまで導入し、このN₂ガスを

D C放電させる。この場合の使用電力は例えば150Wであり、成膜は例えば室温で行われる。なお、N₂ガスの代わりにN₂ガスとArガスとの混合ガスを用いてもよい。また、上に挙げたスパッタリング法はいわゆるD Cスパッタリング法であるが、場合によっては、この5 D Cスパッタリング法の代わりにR Fスパッタリング法を用いてもよい。

次に、上述のようにして非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、Ni薄膜4、WN薄膜5およびW薄膜6が形成されたn⁺型GaAs基板1を例えばアセトンのような有機溶剤に浸けてレジストパターン2を溶解除去することにより、このレジストパターン2上に形成された非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、Ni薄膜4、WN薄膜5およびW薄膜6を除去する。この結果、第4図Cに示すように、レジストパターン2の開口部に対応する部分におけるn⁺型GaAs基板1上にのみ非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、Ni薄膜4、WN薄膜5およびW薄膜6が残される。

次に、これらの非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、Ni薄膜4、WN薄膜5およびW薄膜6、すなわちオーミック電極形成用積層体が形成されたn⁺型GaAs基板1を、例えばRTA(Rapid Thermal Annealing)法や一般的な電気炉による方法により例えば500～6020°Cで短時間、例えば1秒～数分間の熱処理を行う。この熱処理の際の雰囲気としては、例えばN₂ガスや、微量のH₂ガスを添加したN₂ガスから成る雰囲気を用いる。この熱処理の結果、第4図Dに示すように、オーミック電極7が形成される。

第5図は、この第1の実施形態による方法により形成されたオーミック電極7の接触抵抗の熱処理温度依存性の測定結果の一例を示す。測定に用いた試料は、非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、WN薄膜

5 およびW薄膜6の厚さをそれぞれ14nm、25nmおよび50nmに固定し、Ni薄膜4の厚さを9nm、10nmおよび11nmの3水準に変え、これらの非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、Ni薄膜4、WN薄膜5およびW薄膜6をn⁺型GaAs基板1上に形成した後、RTA法により450～655°Cの範囲で温度を変えて1秒間熱処理を行うことによりオーム電極を形成したものである。ただし、これらの熱処理の際の雰囲気としては、5%のH₂ガスが添加されたN₂ガス雰囲気を用いた。また、n⁺型GaAs基板1としては、(100)面方位の半絶縁性GaAs基板にSiをイオン注入してn型化した、不純物濃度が2×10¹⁸Cm⁻³のものを用いた。接触抵抗の測定はTLM(Transmission Line Method)法により行った。第5図より、熱処理温度が550°Cのときに接触抵抗は最も低くなり、約0.2Ωmmと極めて低い接触抵抗値が得られていることがわかる。

第6図は、非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、Ni薄膜4、WN薄膜5およびW薄膜6から成るオーム電極形成用積層体をn⁺型GaAs基板1上に形成した後、RTA法により550°Cで1秒間熱処理を行ってオーム電極7を形成し、さらに400°Cで10時間熱処理を行った後のオーム電極7の表面を撮影した光学顕微鏡写真を示す。ただし、非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、Ni薄膜4、WN薄膜5およびW薄膜6の厚さはそれぞれ14nm、10nm、25nmおよび25nmである。第6図より、400°Cで10時間熱処理を行った後の状態におけるオーム電極7の表面モフォロジーは極めて良好であることのみならず、熱安定性に関しても極めて良好であることがわかる。このように良好な表面モフォロジーが得られる理由は、オーム電極形成用積層体におけるWN薄膜5の存在により、熱処理時に非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3からInが電極表面側

に拡散するのが防止されるためである。

また、オーミック電極7を形成した後に試料を400°Cで10時間熱処理したときのこのオーミック電極7の接触抵抗の経時変化、すなわちオーミック電極7の熱安定性を測定したところ、第7図に示すような結果が得られた。ただし、非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、Ni薄膜4、WN薄膜5およびW薄膜6の厚さはそれぞれ25nm、10nm、25nmおよび50nmである。第7図においては、比較のために、WN薄膜を含まないオーミック電極形成用積層体を用いて形成したオーミック電極、具体的には厚さ25nmの非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層上に厚さ15nmのNi薄膜および厚さ50nmのW薄膜を形成したオーミック電極、および、厚さ23nmの非単結晶InAs層上に厚さ15nmのNi薄膜および厚さ50nmのW薄膜を形成したオーミック電極形成用積層体を用いて形成したオーミック電極の熱安定性の測定結果も示してある。

第7図より、厚さ25nmの非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層上に厚さ15nmのNi薄膜および厚さ50nmのW薄膜を形成したオーミック電極形成用積層体を用いて形成したオーミック電極の接触抵抗は、熱処理開始後1時間程度で増加し始めており、熱安定性が悪いことがわかる。また、厚さ23nmの非単結晶InAs層上に厚さ15nmのNi薄膜および厚さ50nmのW薄膜を形成したオーミック電極形成用積層体を用いて形成したオーミック電極の接触抵抗は、熱処理開始後10時間経過しても一定値を維持していて熱安定性は良好であるが、接触抵抗は0.45Ωmm程度とあまり低くはない。これに対し、WN薄膜を含むオーミック電極形成用積層体を用いて形成したこの第1の実施形態によるオーミック電極7の接触抵抗は、熱処理開

始後 10 時間経過しても一定値を維持していく熱安定性が良好である上に、接触抵抗も $0.2 \Omega \text{ mm}$ 程度と極めて低い。ここで、このように良好な熱安定性が得られる理由は、オーミック電極 7 中には、 AuGe/Ni を用いてオーミック電極を形成した場合にこのオーミック電極中に含まれる $\beta\text{-AuGa}$ のような低融点の化合物が含まれていないため、および、 WN 薄膜 5 により非単結晶 In_{0.7}Ga_{0.3}As 層 3 から In が電極表面側に拡散するのが防止されるためである。

以上のように、この第 1 の実施形態によれば、 n⁺ 型 GaAs 基板 1 上に、非単結晶 In_{0.7}Ga_{0.3}As 層 3、 Ni 薄膜 4、 WN 薄膜 5 および W 薄膜 6 から成るオーミック電極形成用積層体を形成した後、例えば RTA 法により 500 ~ 600 °C の熱処理を例えれば 1 秒行うことにより、低接触抵抗かつ低膜抵抗で表面の平坦性あるいは表面モフオロジーも良好でさらに熱安定性も良好なオーミック電極 7 を容易に形成することができる。このオーミック電極 7 は、第 2 図に示す理想的なエネルギーバンド構造に近いエネルギーバンド構造を有する。このオーミック電極 7 はまた、その最上部が高融点金属である W から成るため、バリアメタルを用いることなく、金属配線を直接接続することができる。また、オーミック電極 7 の形成に用いられる非単結晶 In_{0.7}Ga_{0.3}As 層 3 は、高速で成膜を行うことができるスパッタリング法により形成しているので、このオーミック電極 7 を高い生産性で形成することができる。そして、このオーミック電極 7 の接触抵抗は AuGe/Ni を用いて形成される従来のオーミック電極と同等の低い値であることから、このオーミック電極 7 を用いた半導体素子の特性を損なうこともない。さらに、オーミック電極 7 の形成に必要な熱処理の温度は 500 ~ 600 °C と低いので、この熱処理の際に不純物の拡散が起き、不純物の再分布が生じるのを有效地に防止すること

ができる。

次に、この発明の第2の実施形態について説明する。

この第2の実施形態においては、第1の実施形態において用いた第4図Cに示すようなオーミック電極形成用積層体の代わりに、第8図5に示すようなオーミック電極形成用積層体を用いる。この第8図に示すオーミック電極形成用積層体が第4図Cに示すオーミック電極形成用積層体と異なる点は、W薄膜6が形成されていないことである。その他のこととは、第1の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

この第2の実施形態によっても、第1の実施形態とほぼ同様な良好10特性を有するオーミック電極を容易にしかも高い生産性で形成することができる。

次に、この発明の第3の実施形態について説明する。

この第3の実施形態においては、第1の実施形態において用いた第4図Cに示すようなオーミック電極形成用積層体の代わりに、第9図15に示すようなオーミック電極形成用積層体を用いる。この第9図に示すオーミック電極形成用積層体が第4図Cに示すオーミック電極形成用積層体と異なる点は、W薄膜6上にさらにAl薄膜8が形成されていることである。

この第3の実施形態においては、第4図Bに示すと同様にW薄膜620まで形成した後、このW薄膜6上にAl薄膜8を例えばスパッタリング法や電子ビーム蒸着法により形成する。そして、その後、第1の実施形態で述べたと同様にしてリフトオフを行うことにより、オーミック電極形成部およびn⁺型GaAs基板1上に非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、Ni薄膜4、WN薄膜5、W薄膜6およびAl薄膜825から成るオーミック電極形成用積層体を形成する。この場合、リフトオフを行いやすくするために、リフトオフに用いるレジストパターン

を2層構造にして厚くし、さらにこのレジストパターンが例えばポジ型レジストからなる場合には、下層のレジストパターンに、より感光しやすいレジストを用いるなどの工夫をしてもよい。

この第3の実施形態によれば、オーミック電極形成用積層体の最上5層にA1薄膜8が形成されていることにより、このオーミック電極形成用積層体を用いて形成されるオーミック電極7のシート抵抗の低減を図ることができる。これによって、このオーミック電極7をICの配線やキャパシタの電極として用いることができる。また、このため、配線工程が簡略され、設計の自由度が広がるという利点もある。

10 次に、この発明の第4の実施形態について説明する。

この第4の実施形態においては、GaAs MESFETの製造プロセスにおけるオーミック電極の形成に第2の実施形態によるオーミック電極の形成方法を用い、かつ、オーミック電極の形成と同時にゲート電極をも形成する場合について説明する。

15 すなわち、この第4の実施形態においては、まず、第10図Aに示すように、半絶縁性GaAs基板9のn型チャネル層形成部にドナーとなる不純物を低濃度に選択的にイオン注入するとともに、半絶縁性GaAs基板9のソース領域およびドレイン領域形成部にドナーとなる不純物を高濃度に選択的にイオン注入した後、例えば700～8020℃の温度で熱処理を行うことにより注入不純物を電気的に活性化してn型チャネル層10、n⁺型のソース領域11およびドレイン領域12を形成する。

次に、第10図Bに示すように、第1の実施形態で述べたと同様なリフトオフ法により、オーミック電極形成部に非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3およびNi薄膜4から成る積層体を形成する。

次に、例えばスパッタリング法により全面にWN薄膜を形成した後、

このWN薄膜上に、形成すべきゲート電極およびオーミック電極に対応した形状のレジストパターン（図示せず）をリソグラフィー法により形成し、このレジストパターンをマスクとしてWN薄膜を例えばC F₄ / O₂ 系のエッチングガスを用いた反応性イオンエッチング（RIE）法によりエッチングする。その後、レジストパターンを除去する。これによって、第10図Cに示すように、オーミック電極形成部に非単結晶In_{0.7}Ga_{0.3}As層3、Ni薄膜4およびWN薄膜5から成るオーミック電極形成用積層体が形成されるとともに、n型チャネル層10上にWN薄膜から成るゲート電極13が形成される。なお、上記のWN薄膜を用いて配線を形成することも可能である。

次に、例えばRTA法により500～600℃の温度で熱処理を行う。これによって、第10図Dに示すように、第1の実施形態で述べたと同様にしてソース電極またはドレイン電極として用いられるオーミック電極14、15が形成され、目的とするGaAs MESFETが完成される。

以上のように、この第4の実施形態によれば、ソース電極またはドレイン電極として用いて好適な良好な特性を有するオーミック電極14、15を容易に形成することができ、しかもこれらのオーミック電極14、15の形成に用いられるオーミック電極形成用積層体の形成時にゲート電極13を同時に形成することができる。これによって、GaAs MESFETの製造工程の簡略化を図ることができる。

次に、この発明の第5の実施形態について説明する。

この第5の実施形態においては、n型III-V族化合物半導体に対するオーミック電極とp型III-V族化合物半導体に対するオーミック電極とを両方とも必要とする半導体素子を製造する場合に、これらのオーミック電極をこの発明によるオーミック電極形成用積層体を用いて

同時に形成する。

具体的には、例えば、G a A s J F E Tの製造において、半絶縁性G a A s基板中にp⁺型のゲート領域、n型のソース領域およびドレイン領域を形成した後、これらのゲート領域、ソース領域およびドレイン領域上にそれぞれ例えば第1の実施形態と同様なオーミック電極形成用積層体を形成し、その後例えば500～600℃の温度で熱処理を行うことにより、これらのゲート領域、ソース領域およびドレイン領域上にそれぞれのオーミック電極を同時に形成することができる。

また、III-V族化合物半導体を用いたヘテロ接合バイポーラトランジスタ（H B T）、例えば、エミッタ層にn型A l G a A s層を用い、ベース層にp型G a A s層を用い、コレクタ層にn型G a A s層を用い、これらのエミッタ層、ベース層およびコレクタ層に対するオーミック電極が必要なH B Tの製造において、これらのエミッタ層、ベース層およびコレクタ層上のオーミック電極形成部に例えば第1の実施形態と同様なオーミック電極形成用積層体を形成し、その後例えば500～600℃の温度で熱処理を行うことにより、これらのエミッタ層、ベース層およびコレクタ層上にそれぞれのオーミック電極を同時に形成することができる。

以上、この発明の実施形態につき具体的に説明したが、この発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。

例えば、上述の第1の実施形態～第4の実施形態において用いられたN i薄膜4の代わりに、C o薄膜またはA l薄膜を用いてもよい。

また、上述の第1の実施形態～第3の実施形態においては、オーミック電極形成用積層体をリフトオフ法により形成しているが、このオ

一ミック電極形成用積層体は、 n^+ 型G a A s基板1の全面にこのオーミック電極形成用積層体を構成する層をスパッタリング法などにより順次形成した後にこれらをエッチング法によりオーミック電極の形状にパターニングすることにより形成するようにしてよい。

5 さらに、上述の第1の実施形態～第4の実施形態においては、G a A s基板に対するオーミック電極の形成にこの発明を適用した場合について説明したが、例えばエピタキシャル成長などにより形成されたG a A s層に対するオーミック電極の形成にこの発明を適用することも可能である。

10 また、この発明は、III-V族化合物半導体を用いた高電子移動度トランジスタ（HEMT）、例えばA l G a A s/G a A s H E M Tにおけるソース領域およびドレイン領域に対するオーミック電極の形成に適用することも可能である。

15 以上述べたように、この発明によれば、III-V族化合物半導体基体上に順次形成された、非単結晶半導体層および少なくとも窒化金属薄膜を含む薄膜から成るオーミック電極形成用積層体を熱処理することによって、III-V族化合物半導体に対する、実用的に満足しうる特性を有するオーミック電極を容易に形成することができる。

請求の範囲

1. III-V族化合物半導体基体上に順次形成された、非単結晶半導体層および少なくとも窒化金属薄膜を含む薄膜から成ることを特徴とするオーム電極形成用積層体。
- 5 2. 上記III-V族化合物半導体基体は GaAs、AlGaAs または InGaAs から成ることを特徴とする請求の範囲第1項記載のオーム電極形成用積層体。
3. 上記非単結晶半導体層は非単結晶 $In_x Ga_{1-x} As$ 層 ($0 < x \leq 1$) であることを特徴とする請求の範囲第1項記載のオーム電極形成用積層体。
- 10 4. 上記薄膜は金属薄膜および上記金属薄膜上に形成された窒化金属薄膜を有することを特徴とする請求の範囲第1項記載のオーム電極形成用積層体。
5. 上記窒化金属薄膜上にさらに高融点金属薄膜が形成されていることを特徴とする請求の範囲第4項記載のオーム電極形成用積層体。
- 15 6. 上記高融点金属薄膜上にさらに配線用金属薄膜が形成されていることを特徴とする請求の範囲第5項記載のオーム電極形成用積層体。
7. 上記金属薄膜は Ni 薄膜、Co 薄膜または Al 薄膜であり、上記窒化金属薄膜は WN 薄膜、WSiN 薄膜、TaN 薄膜、TaSiN 薄膜、TiN 薄膜、TiSiN 薄膜または TiON 薄膜であることを特徴とする請求の範囲第4項記載のオーム電極形成用積層体。
- 20 8. 上記高融点金属薄膜は W 薄膜、Ta 薄膜または Mo 薄膜であることを特徴とする請求の範囲第5項記載のオーム電極形成用積層体。
- 25 9. III-V族化合物半導体基体上に順次形成された、非単結晶半導体層および少なくとも窒化金属薄膜を含む薄膜であって、上記非単結晶

半導体層と上記薄膜との間のエネルギー障壁の高さは上記III-V族化合物半導体基体と上記薄膜との間のエネルギー障壁の高さよりも低いものから成ることを特徴とするオーミック電極形成用積層体。

10. III-V族化合物半導体基体上に順次形成された、非単結晶半導
5 体層および少なくとも窒化金属薄膜を含む薄膜から成るオーミック電
極形成用積層体を熱処理することによって得られることを特徴とする
オーミック電極。

11. 上記オーミック電極形成用積層体を熱処理する温度は500～
600°Cであることを特徴とする請求の範囲第10項記載のオーミック
10 電極。

12. 上記III-V族化合物半導体基体はGaAs、AlGaAsまたは
InGaAsから成る上記オーミック電極形成用積層体を熱処理す
ることによって得られることを特徴とする請求の範囲第10項記載の
オーミック電極。

15. 13. 上記非単結晶半導体層は非単結晶In_xGa_{1-x}As層(0 <
x ≤ 1)である上記オーミック電極形成用積層体を熱処理することに
よって得られることを特徴とする請求の範囲第10項記載のオーミック
電極。

14. 上記薄膜は金属薄膜および上記金属薄膜上に形成された窒化金
20 屬薄膜を有する上記オーミック電極形成用積層体を熱処理することに
よって得られることを特徴とする請求の範囲第10項記載のオーミック
電極。

15. 上記窒化金属薄膜上にさらに高融点金属薄膜が形成されている
上記オーミック電極形成用積層体を熱処理することによって得られる
25 ことを特徴とする請求の範囲第14項記載のオーミック電極。

16. 上記高融点金属薄膜上にさらに配線用金属薄膜が形成されてい

る上記オーミック電極形成用積層体を熱処理することによって得られることを特徴とする請求の範囲第15項記載のオーミック電極。

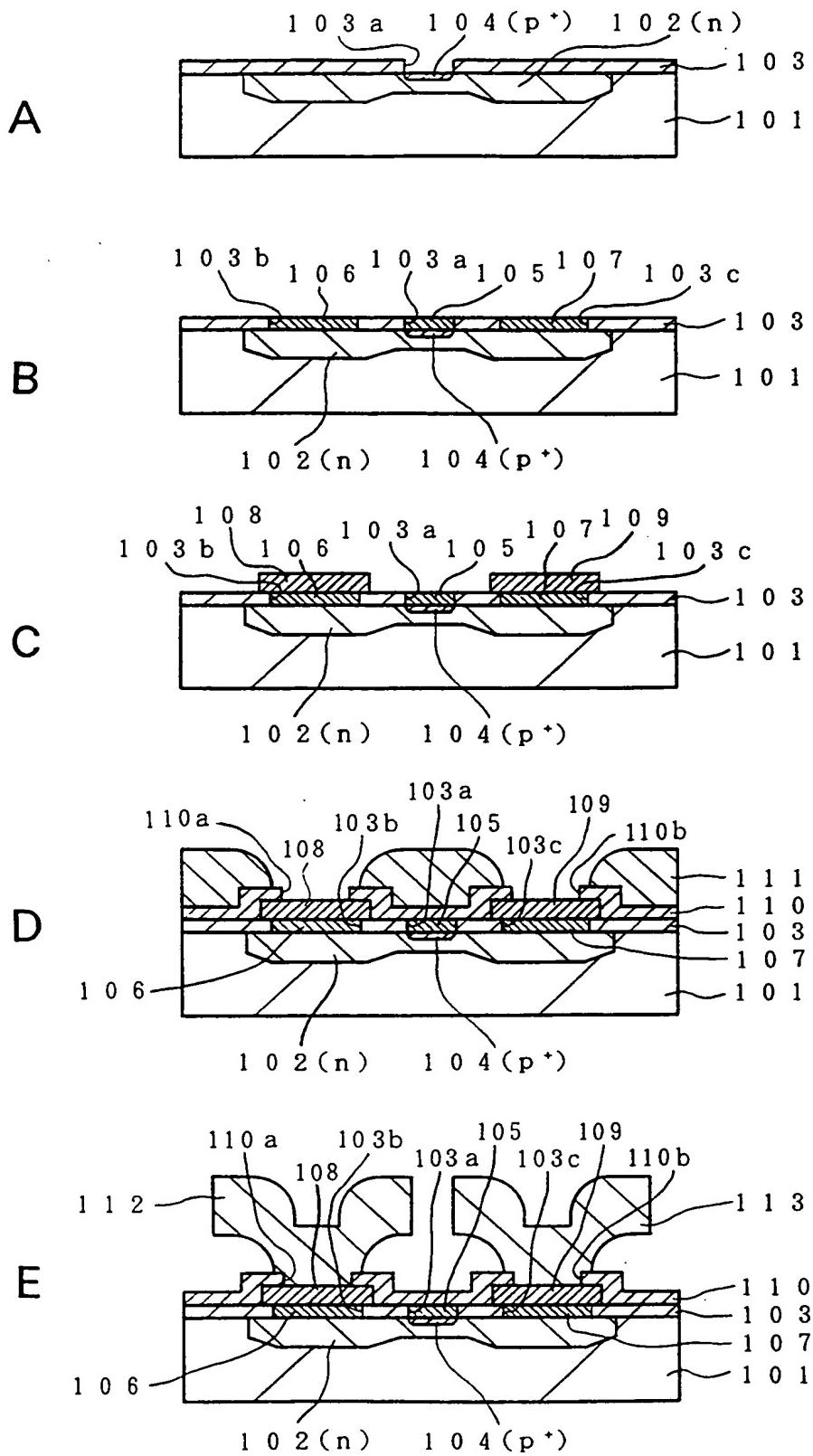
17. 上記金属薄膜はNi薄膜、Co薄膜またはAl薄膜であり、上記窒化金属薄膜はWN薄膜、WSiN薄膜、Ta_N薄膜、TaSiN薄膜、Ti_N薄膜、TiSiN薄膜またはTi_{ON}薄膜である上記オーミック電極形成用積層体を熱処理することによって得られることを特徴とする請求の範囲第14項記載のオーミック電極。
5

18. 上記高融点金属薄膜はW薄膜、Ta薄膜またはMo薄膜である上記オーミック電極形成用積層体を熱処理することによって得られる
10ことを特徴とする請求の範囲第15項記載のオーミック電極。

19. III-V族化合物半導体基体上に形成されたオーミック電極であ
って、

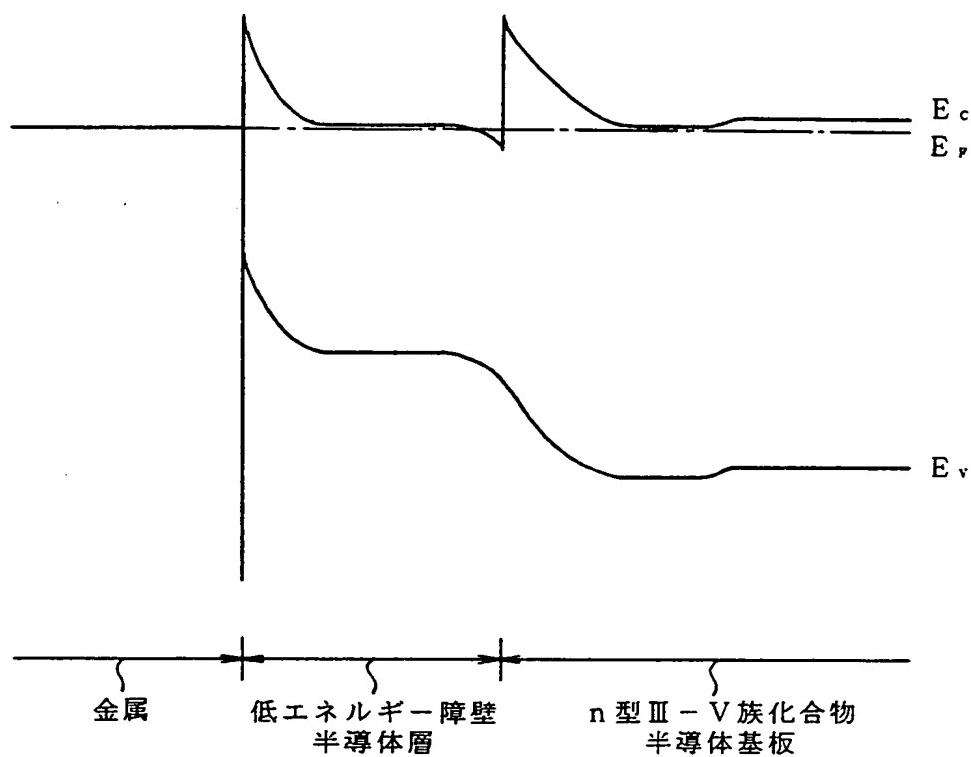
非単結晶半導体層および少なくとも窒化金属薄膜を含む薄膜を有し、
上記非単結晶半導体層と上記薄膜との間のエネルギー障壁の高さは上
15記III-V族化合物半導体基体と上記薄膜との間のエネルギー障壁の高
さよりも低いものから成るオーミック電極形成用積層体を熱処理する
ことによって得られることを特徴とするオーミック電極。

第 1 図

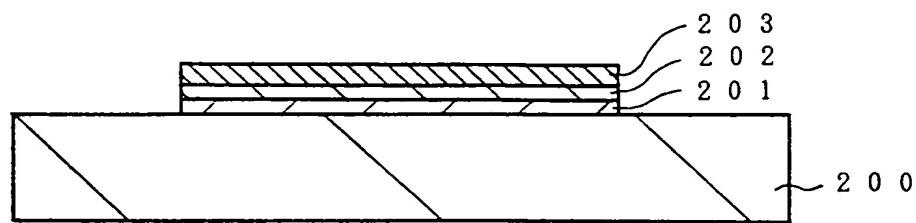


THIS PAGE BLANK (USPTO)

第2図

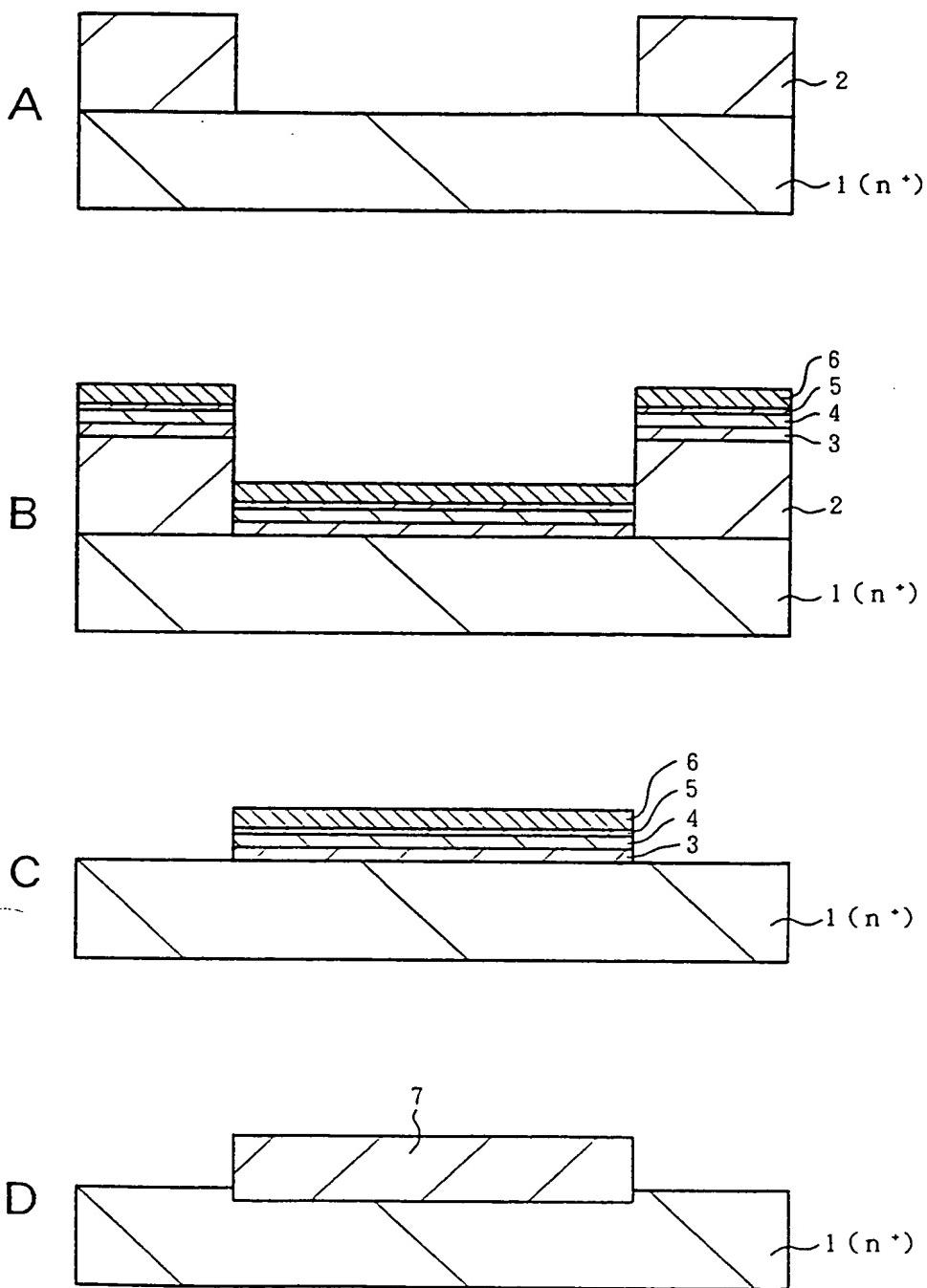


第3図



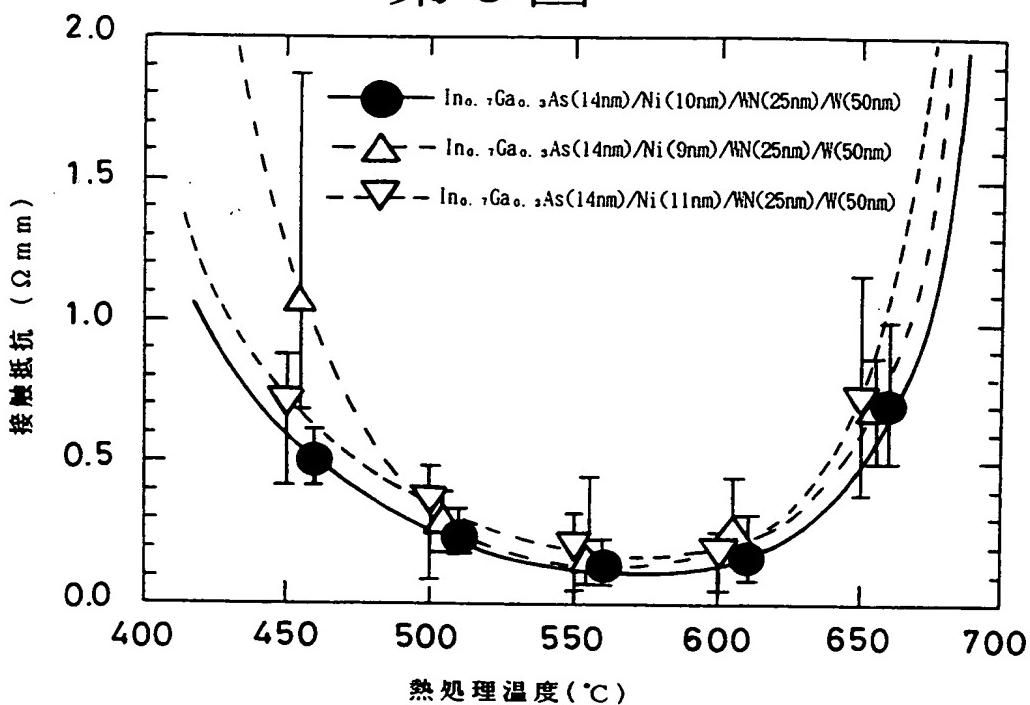
THIS PAGE BLANK (USPTO)

第4図

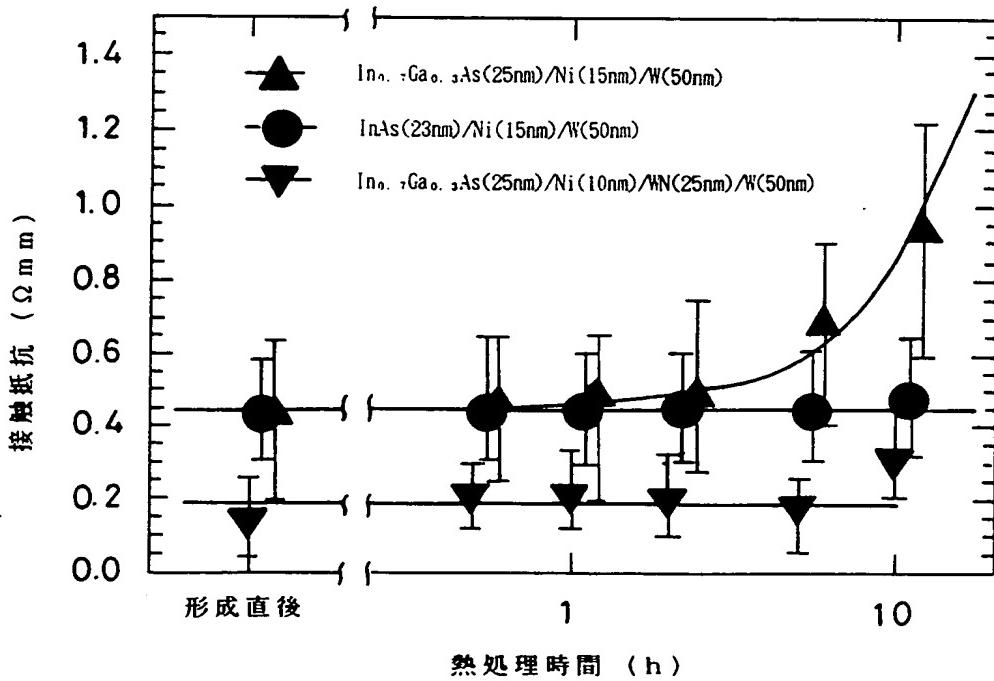


THIS PAGE BLANK (USPTO)

第5図



第7図



THIS PAGE BLANK (USPTO)

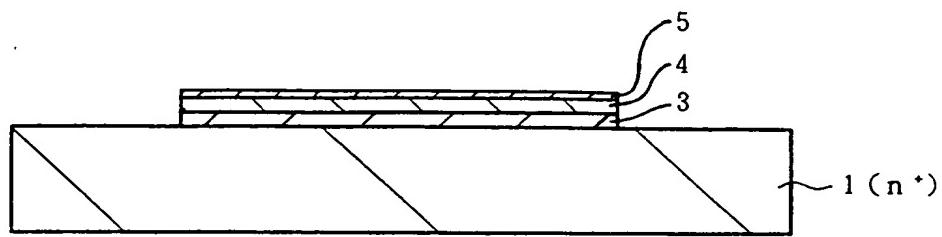
第6図



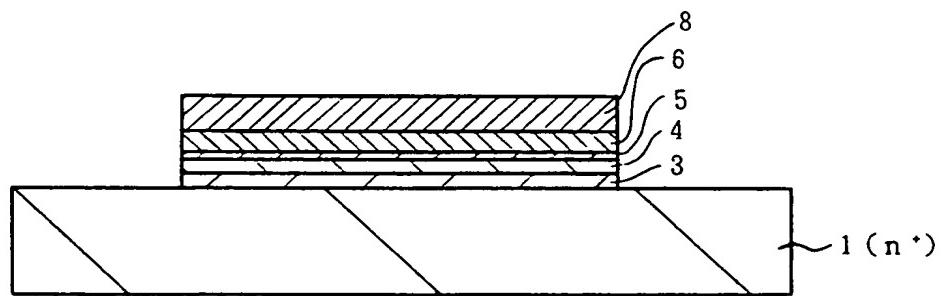
50 μm

THIS PAGE BLANK (USPTO)

第8図

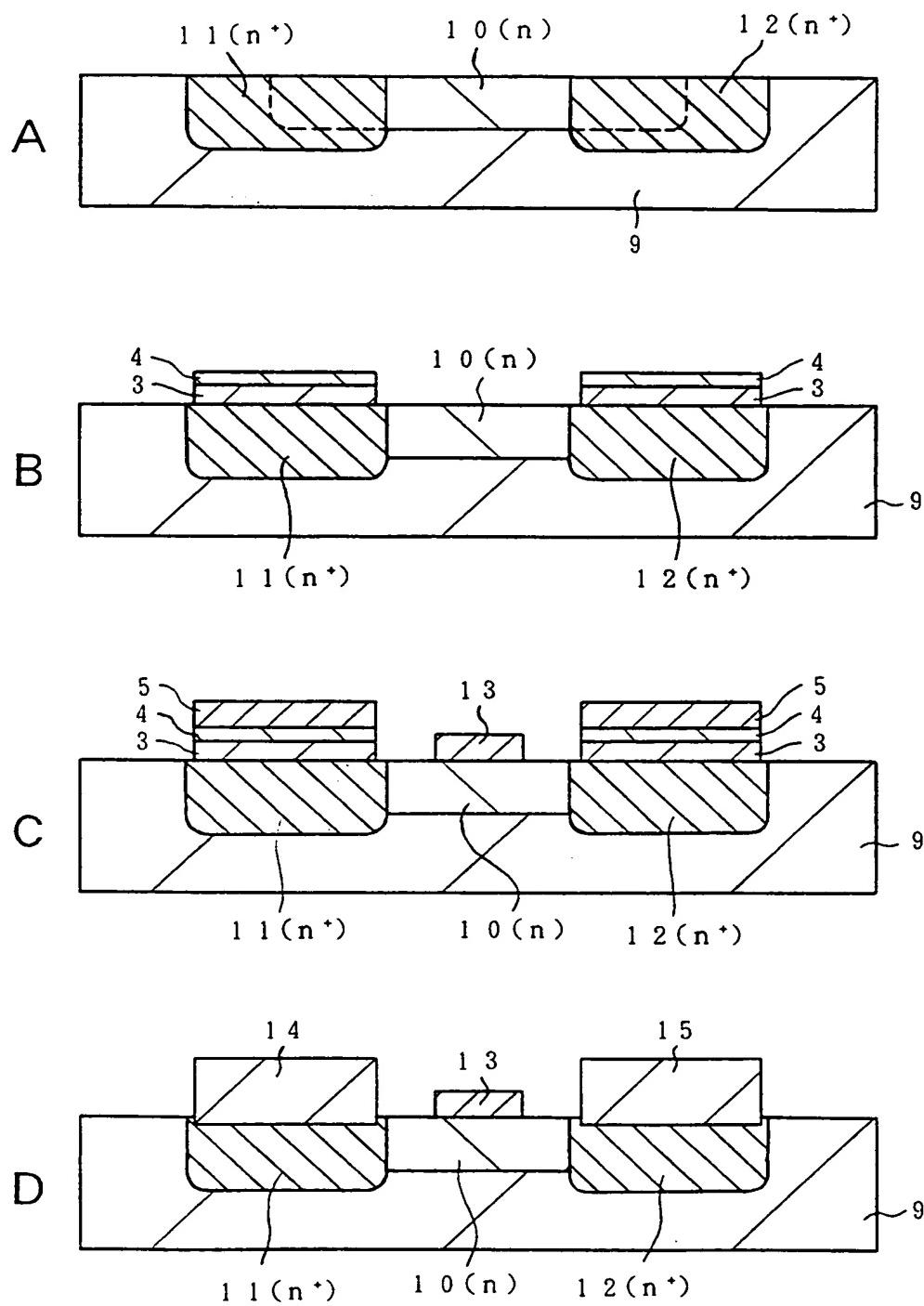


第9図



THIS PAGE BLANK (USPTO)

第10図



THIS PAGE BLANK (USPTO)

1 : n⁺ 型 GaAs 基板

3 : 非単結晶 In_{0.7} Ga_{0.3} As 層

4 : Ni 薄膜

5 : WN 薄膜

6 : W 薄膜

7 : オーム ミック電極

8 : Al 薄膜

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP96/02318

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int. Cl⁶ H01L21/28

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int. Cl⁶ H01L21/28, 29/40-417, 43, 45

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1964 - 1995

Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971 - 1993

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP, 7-94444, A (Sony Corp.), April 7, 1995 (07. 04. 95), Claim 1 & EP, 649167, A	1, 9, 10, 19
A	JP, 6-267887, A (Sony Corp.), September 22, 1994 (22. 09. 94), Claim 1 (Family: none)	1, 9, 10, 19
A	JP, 1-166556, A (Hitachi, Ltd.), June 30, 1989 (30. 06. 89), Claim 1 (Family: none)	1, 9, 10, 19

 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

- Special categories of cited documents:
- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

November 11, 1996 (11. 11. 96)

Date of mailing of the international search report

November 19, 1996 (19. 11. 96)

Name and mailing address of the ISA/

Japanese Patent Office

Facsimile No.

Authorized officer

Telephone No.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))
Int. C16 H01L21/28

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))
Int. C16 H01L21/28, 29/40~417, 43, 45

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報1964-1995年

日本国公開実用新案公報1971-1993年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP, 7-94444, A (ソニー株式会社) 7. 4月. 1995(07.04.07), クレーム1, EP, 649167, A	1, 9, 10, 19
A	JP, 6-267887, A (ソニー株式会社) 22. 9月. 1994(22.09.94), クレーム1, (ファミリーなし)	1, 9, 10, 19
A	JP, 1-166556, A (株式会社日立製作所) 30. 6月. 1989 (30.06.89), クレーム1, (ファミリーなし)	1, 9, 10, 19

C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
- 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

11. 11. 96

国際調査報告の発送日

19.11.96

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

國島 明弘

印 4M 8932

電話番号 03-3581-1101 内線

THIS PAGE BLANK (USPRO)